การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด1.4 กิโลจูล

นายสิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DESIGN AND CONSTRUCTION OF 1.4 kJ PULSED INDUCTIVELY COUPLED PLASMA DEVICE

Mr. Sidthisak Chaisombat

สูนย์วิทยทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Physics Department of Physics Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2010 Copyright of Chulalongkorn University

หวขอวทยานพนธ
โดย
สาขาวิชา
ดาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพบล์หลัก

การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วง ชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด1.4 กิโลจูล นายสิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ ฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน

คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญ**ามหาบัณ**ฑิต

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

Chimber waren

(อาจารย์ ดร. สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์)

...... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ผู้ช่วยศาส์ตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคคเณศ ตุงคะสมิต)

/กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 2 2

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์)

สิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ: การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิด คู่ควบเหนี่ยวนำขนาด1.4 กิโลจูล (DESIGN AND CONSTRUCTION OF 1.4 kJ PULSED INDUCTIVELY COUPLED PLASMA DEVICE) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน, 107 หน้า.

J

เครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดควบคู่เหนี่ยวนำหรือเครื่องพีไอซีพี คือเครื่อง ้กำเนิดพลาสมาที่ดัดแปลงมาจาก<mark>เครื่องกำเนิ</mark>ดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบัน ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานใน<mark>หลายด้าน เนื่</mark>องด้วย<mark>กระบวนการ</mark>เกิดพลาสมาภายในที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่สั้นจึงเหมาะกับงานด้านการปรับปรุงพื้นผิววัสดุที่ไม่ทนความร้อน งานวิจัยนี้ได้ ทำการสร้างเครื่องพี่ไอซีพี แล้วศึกษาสมบัติของเครื่องและสมบัติของพลาสมาที่กำเนิดจาก เครื่อง ซึ่งเป็นตัวแปรพื้นฐานที่มีประโยชน์ในการนำมาพัฒนา และศึกษาเครื่องกำเนิด ปฏิกิริยาฟิวชันได้ในอนาคต ขดลวดโรโกวสกี้วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร หัววัด สนามแม่เหล็กวัดการเคลื่อนที่ของพลาสมา และสเปคโตรมิเตอร์วัดอุณหภูมิอิเล็กตรอน ได้ น้ำมาวัดขณะที่เครื่องมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุเท่ากับ1.4 2.4 และ4.32 กิโลจูล ซึ่ง สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้ 256 336และ430 กิโลแอมแปร์ตามลำดับ เมื่อ เครื่องมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 1.4 กิโลจูล สามารถวัดความเร็วเฉลี่ยสูงสุดของ พลาสมาจากก๊าซอาร์กอน ออกซิเจน และในโตรเจนได้ 2 4x10⁴ 3.5 x10⁴ และ 4.2 x10⁴ เมตร ต่อวินาทีตามลำดับ ซึ่งวัดได้จากตำแหน่ง 3.46 ถึง1.46 เซนติเมตรจากแกนกลาง จากการ ทดลองพบว่าความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาที่วัดได้มีค่าเพิ่มขึ้นตามพลังงานที่ให้ ขณะที่ลดลง ตามระยะทางที่บีบตัว ตามความดันที่เพิ่มขึ้นและตามมวลโมเลกุลของพลาสมาที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับแบบจำลองทางทฤษฎีพบว่าความเร็วของพลาสมาเพิ่มขึ้นในช่วงแรกและ ลดลงเมื่อเข้าใกล้ศูนย์กลางซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง ขณะที่อุณหภูมิอิเล็กตรอนจาก แบบจำลองทางทฤษฎีลดลงตามความดันที่เพิ่มขึ้น และยังพบว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าใน วงจรกาจมีผลต่อความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของพลาสมา

ลายมือชื่อนิสิต สิกรีสิกส์ โรงเฉละ ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.../_____

ภาควิชา......พิสิกส์...... สาขาวิชา.....พิสิกส์...... ปีการศึกษา2553......

5072512223: MAJOR PHYSICS KEYWORDS: PICP / THETA PINCH/ PULSED PLASMA

SIDTHISAK CHAISOMBAT: DESIGN AND CONSTRUCTION OF 1.4 kJ PULSED INDUCTIVELY COUPLED PLASMA DEVICE. ADVISOR: ASST. PROF. RATTACHAT MONGKOLNAVIN, Ph.D., 107 pp.

A pulsed inductively coupled plasma device (PICP) is modified from a small fusion device. The PICP has been used in many applications as a short pulse plasma generation such as taken to operate in the surface improvement of non-thermal materials. In this research, PICP device has been constructed which the properties of a PICP device were studied as well as the plasma dynamics and the plasma properties. These parameters are useful for future development and study of small fusion devices. Rogowski coil was used to measure the discharge current, magnetic probe was used to measure the position of plasma and the plasma velocity and optical spectrometer was used to measure plasma electron temperature. Results from the experiment show the energy stored of 1.4, 2.4 and 4.32 kJ in the capacitor bank produced the discharge current of 256, 336 and 430 kA, respectively. When the 1.4 kJ energy is stored in capacitor bank, the maximum average velocity of Ar, O_2 and N_2 plasma are 2.4x10⁴, 3.5 x10⁴ and 4.2 x10⁴ m/s, respectively there were measured at 3.46 - 1.46 cm. from the centre of quartz tube. The Experiment shows when the molecular mass, the operating pressure and the displacement increases, then the velocity of plasma decreases. Results from the experiment were compared with results from the simulation models in order to understand the dynamics particularly the corresponding results of the velocity of plasma and the displacement. Furthermore, results from the simulation models show the electron temperature decreases with the operating pressure increases. The frequency of discharge current also affected the velocity of plasma.

Department :Physics	Student's Signature
Field of Study :Physics	Advisor's Signature
Academic Year :	/

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถสำเร็วลุล่วงได้ เนื่องจากบุคคลต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและกำลังใจในการทำงาน

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยกระตุ้นเตือนในการทำงาน ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือด้าน ต่างๆ และแนวคิดในการทำงาน ที่เป็นตัวอย่างอันดีเสมอมา ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร. เชา ชาน วอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ที่ ช่วยเหลือให้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นประโยชน์กับงานวิจัยครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์ ที่ได้บ่มเพาะ ขัดเกลา และเป็นกำลังใจให้เสมอมา

ขอขอบคุณ <mark>พี่หลิว คุณดุสิต งามรุ่งโรจน์ ซึ่ง ถ่ายทอด ความรู้ ช่วยปูพื้นฐานใน</mark> งานวิจัยและความช่วยเหลือต่างๆ

ขอขอบคุณ คุณปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์ ซึ่งให้การช่วยเหลืองานด้านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่เอก คุณ เอกลักษณ์ จันเทมะ สำหรับกำลังใจในการ ทำงาน และขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแลปพลาสมาภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ ร่วมกันมาตลอดการทำวิทยานิพนธ์

ขอบคุณ คุณสุรางค์ สุมนาวดีที่เป็นห่วงและคอยให้กำลังใจเสมอ สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เป็นห่วงและสนับสนุนด้วยดีเสมอ มา รวมถึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ବ
กิตติกรรมประกาศ	ନ୍ଥ
สารบัญ	ป
สารบัญภาพ	ณ
สารบัญตาราง	ବି
บทที่1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาแล <mark>ะความสำคัญของงานวิจัย</mark>	1
1.2 วัตถุประสงค์	3
1.3 วิธีการดำเนินการวิจัย	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจ <mark>ะได้รับ</mark>	3
1.5 ลำดับขั้นตอนใน <mark>การเสนอผลงานวิจัย</mark>	4
บทที่ 2 เครื่องพี่ไอซีพี	
2.1 ส่วนประกอบของเครื่อง <mark>พีไอซีพี</mark>	5
2.2 กระบวนการเกิดพล <mark>าสมาภายในเครื่องพีไอซี</mark> พีและเครื่องที่ต้าพินช์	7
2.3 อุปกรณ์สำคัญของเครื่องพีไอซีพี	9
2.3.1 ตัวเก็บ <mark>ป</mark> ระจุความจุสูงและเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง	9
2.3.2 สปาร์คแก๊ปสวิทช์ และอิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์	11
2.3.3 ขดลวดรอบเดียว	13
2.3.4 ท่อควอทซ์และปั้มสุญญากาศ	13
บทที่ 3 แบบจำลองทางทฤษฎีของการแผ่รังสีและการเคลื่อนที่ของพลาสมา	16
3.1 แบบจำลองการแผ่รังสีของพลาสมา	17
3.1.1 แบบจำลองสมดุลอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่	20
3.2 แบบจำลองของวงจรของเครื่องพีไอซีพี	22
3.3 แบบจำลองทางทฤษฎีของการเคลื่อนที่ของกระแสพลาสมา	26
บทที่ 4 การออกแบบ การสร้างเครื่องพีไอซีพี และเครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดลอง	30
4.1 การออกแบบและการสร้างเครื่องพีไอซีพี	30

	หน้า
4.1.1 การออกแบบและสร้างภาชนะสุญญากาศ	33
4.1.2 การออกแบบและสร้างสปาคแก๊บสวิทช์	35
4.1.3 การออกแบบและสร้างขดลวดรอบเดียว	38
4.1.4 การสร้างเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง	41
4.1.5 การใช้งานเครื่องพีไอซีพี	44
4.2 เครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดล <mark>อง</mark>	46
4.2.1 ขดลวดโรโกวส <mark>กี้ (Rogowski coil)</mark>	46
4.2.2 หัววัดสนาม <mark>แม่เหล็ก (M</mark> agnetic <mark>probe</mark>)	52
4.2.3 เครื่องสเป <mark>คโตรมิเตอร์ (Optical Emission Spe</mark> ctroscopy : OES)	60
บทที่ 5 การทดลองและผล <mark>การทดลอง</mark>	65
5.1 การวัดค่ากร <mark>ะแ</mark> สไฟฟ้าภายในวงจรของเครื่องพีไอซีพี	66
5.2 การวัดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในเครื่องพีไอซีพี	70
5.3 การวัดค่าอุณห <mark>ภูมิอิเล็กต</mark> รอนภายในเครื่องพี่ไอซีพี	83
บทที่ 6 วิเคราะห์และสรุปผล <mark>การท</mark> ดลอง	91
6.1 สมบัติของเครื่องพี่ไ <mark>อ</mark> ซีพี	91
6.2 สมบัติของพลาสมาจากเ <mark>ครื่องพี่ไอซีพี</mark> ่	91
6.2.1 ความเร็วของพลาสมา	91
6.2.2 อุณหภูมิอิเล็กตรอน	92
6.3 ข้อเสนอแนะส <mark>ำ</mark> หรับงานในอนาคต	92
รายการอ้างอิง	94
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	97

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
5.1	ผลการหาตัวแปร K ที่ได้จากวงจรเสมือน	66
5.2	ผลการหากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรและช่วงเวลาการคายประจุ	67
5.3	รายละเอียดของตัวเก็บประจุของเครื่องพีไอซีพีและเครื่องที่ต้าพินซ์	68
5.4	ผลการวัดเวลาที่พลาสมาชีทเคลื่อนที่มาถึงณ.ตำแหน่ง 3.46, 2.46	
	และ1.46 เซนติเมตร	71
5.5	ผลการหาความเร็ว <mark>เฉลี่ยของพลาสมาระหว่างตำ</mark> แหน่ง 3.46 ถึง 2.46	
	เซนติเมตร และ <mark>2.46 ถึง1.4</mark> 6 เซนติเม <mark>ตร</mark>	80
5.6	ผลการหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจากก๊าซอาร์กอน	83
5.7	ผลการหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจากก๊าซไนโตรเจน	83
5.8	ผลการหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจากก๊าซออกซิเจน	83



สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	ภาพเครื่องที่ต้าพินช์	5
2.2	แผนภาพแสดงการประกอบอุปกรณ์ของเครื่องพีไอซีพี	6
2.3	แผนภาพแสดงการเกิดพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพีและที่ต้าพินช์	7
2.4	แผนภาพแสดงทิศทางกระแสไฟฟ้า กระแสพลาสมา และสนามแม่เหล็ก	8
2.5	ภาพของตัวเก็บประจุ <mark>ความจุสูงของเครื่องพีไอ</mark> ซีพีและเครื่องที่ต้าพินช์	9
2.6	รูปวาดแสดงวงจ <mark>รการต่อตัวเ</mark> ก็บป <mark>ระจุ</mark>	10
2.7	วงจรของเครื่อ <mark>งชาร์จประจุความต่างศักย์สูง</mark>	10
2.8	แบบร่างแสดงส่วนประกอบของสปาร์คแก๊ปสวิทช์	11
2.9	แผนภาพแสดงการต่อสปาร์คแก๊บสวิตซ์เข้ากับวงจรของเครื่องที่ต้าพินช์	12
2.10	แบบร่างแสดงขนาดของขดลวดรอบเดียว	13
2.11	รูปวาดแสดงข <mark>นาดของท่</mark> อควอ <mark>ทซ์</mark>	14
2.12	แผนภาพแสดงก <mark>ารต่อ</mark> ท่อควอทซ์เข้ากับอุปกรณ์ต่าง	14
3.1	รูปวาดแสดงวงจรข <mark>องเครื่องพีไอซีพี</mark>	22
3.2	แผนภาพแสดงสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้า	
	I _c ที่ไหลในวงจร	23
3.3	แผนภาพแสดงแบบจำลองสลักแสดงการเคลื่อนที่ของพลาสมา	
	ภายในเครื่องพี่ไอซีพี	26
4.1.1	แผนภาพของเครื่องพีไอซีพีตามแบบเสนออนุมัติโครงร่างวิทยานพนธ์	31
4.1.2	แบบร่างแสดงการจัดวางภาชนะสุญญากาศเหนือตัวเก็บประจุ	32
4.1.3	แผนภาพแสดงภาชนะสุญญากาศ	33
4.1.4	ภาพฝาปิดท่อควอทซ์ในการสร้างภาชนะสุญญากาศ	34
4.1.5	แบบร่างสปาร์คแก๊บสวิทช์	36
4.1.6	ภาพสปาร์คแก๊บเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ	37
4.1.7	แบบร่างของขดลวดรอบเดียว	39
4.1.8	ภาพขดลวดรอบเดียวที่สร้างและทำการติดตั้งแล้วเสร็จ	40
4.1.9	ภาพข้อต่อสำหรับใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า	40
4.1.10	วงจรเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง	41

ภาพที่		หน้า
4.1.11	วงจรอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์	41
4.1.12	ภาพเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง	42
4.1.13	กราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าที่ลดทอนจากตัวเก็บประจุและ	
	ความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุขณะทำการชาร์จ	42
4.1.14	ภาพเครื่องพีไอซีพีที่ทำการสร้างแล้วเสร็จ	43
4.1.15	ภาพแสดงรายละเอียดขอ <mark>งเครื่อ</mark> งซาร์จประจุความต่างศักย์สูง	44
4.1.16	กราฟแสดงควมดัน <mark>สูงสุดที่สา</mark> มารถเกิ <mark>ดพลาสมา</mark> จากก๊าซไนโตรเจน	
	ที่พลังงานต่างๆของเครื่องพี่ไอซีพี	45
4.2.1	รูปวาดขดลว <mark>ดโรโกวสกี้</mark>	46
4.2.2	รูปวาดการต่ <mark>อขดลวดโรโกวส</mark> กี้รอบ <mark>ข</mark> ั้วไฟฟ้า	47
4.2.3	ภาพขดลวดโรโกวสกี้ที่ใช้ในการทดลอง	47
4.2.4	ภาพการต่อข <mark>ดลวดโรโกวส</mark> กี้รอบขั้วไฟฟ้าในการทดลองจริง	48
4.2.5	รูปวาดวงจรเพื่อใช้วัดสัญญาณ	48
4.2.6	ภาพการต่อสาย <mark>สัญญาณจากภายนอกเข้าสู่ออส</mark> ซิลโลสโคป	49
4.2.7	วงจรเสมือน	50
4.2.8	รูปแสดงสัญญาณไฟฟ้าที่วัดได้ขดลวดโรโกวสกี้	50
4.2.9	แผนภาพแสดงการจัดวางหัววัดสนามแม่เหล็ก	52
4.2.10	รูปวาดหัววัดสนามแม่เหล็ก	53
4.2.11	แผนภาพแสดงการจัดวางหัววัดสนามแม่เหล็ก	53
4.2.12	ภาพการจัดวางหัววัดสนามแม่เหล็กในการทดลอง	53
4.2.13	ภาพสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กที่ออสซิลโลสโคป	54
4.2.14	ภาพสัญญาณที่วัดได้จากหัววัดสนามแม่เหล็ก	55
4.2.15	วงจรการต่อซิลิคอนพินไดโอด	56
4.2.16	ภาพการติดตั้งซิลิคอนพินไดโอด	56
4.2.17	ภาพแสดงสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กและซิลิคอนพินไดโอด	57
4.2.18	ภาพขยายของสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็ก	58
4.1.19	ภาพสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กที่ปรากฏในออสซิลโลสโคป	59
4.2.20	ภาพการจัดวางเครื่องสเปคโตรสโคปีในการทดลอง	60
4.2.21	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและความเข้มแสง	61

ป

ภาพที่		หน้า
4.2.22	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอิเล็กตรอน และค่า R	63
4.2.23	แผนภาพแสดงนั้นตอนการคำนวณหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอน	64
5.1	แผนภาพการทดลองด้วยเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด	65
5.2	รูปแสดงค่าที่ทำการวัดในสัญญาณจากขดลวดโลโกวสกี้ที่วัดจากวงจรเสมือน	66
5.3	กราฟความสัมพันธ์ของพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและกระแสไฟฟ้า	
	ที่ใหลในวงจร	67
5.4	กราฟแสดงความส <mark>ัมพันธ์ระห</mark> ว่างพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	
	กับเวลาในการค <mark>ายประจุ</mark>	68
5.5	กราฟแสดงสัญญาณ <mark>จากขดลว</mark> ดโรโกวสกี้	69
5.6	แผนภาพการ <mark>จัดวางหัววัดสน</mark> าม <mark>แม่เหล็กและระยะที่วัด</mark> จากศูนย์ท่อควอทซ์	70
5.7	กราฟแสดงค <mark>วามสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลาง</mark>	
	ท่อควอทซ์ขอ <mark>งพลาสมาจากก๊าซอาร์กอนในเครื่องพีไอ</mark> ซีพีขนาด 1.4 kJ	72
5.8	กราฟแสดงคว <mark>ามสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัด</mark> และระยะจากจุดศูนย์กลาง	
	ท่อควอทซ์ของพ <mark>ลาสมาจากก๊าซอ๊อกซิเจนในเครื่</mark> องพี่ไอซีพีขนาด 1.4 kJ	72
5.9	กราฟแสดงความสัมพัน <mark>ธ์ระหว่างเวลาที่มา</mark> ถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลาง	
	ท่อควอทซ์ของพลาสม <mark>าจากก๊าซไนโตรเจนในเครื่อง</mark> พี่ไอซีพีขนาด 1.4 kJ	73
5.10	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลาง	
	ท่อควอทซ์ขอ <mark>งพลาสมาจากก๊าซสามชนิดในเครื่องพีไอ</mark> ซีพีขนาด 1.4 kJ	73
5.11	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงตำแหน่ง1.64 เซนติเมตรจากจุด	
	ศูนย์กลางท่อควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซสามชนิด	74
5.12	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลาง	
	ท่อควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซอาร์กอนในเครื่องพีไอซีพีพลังงานต่างๆ	75
5.13	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลาง	
	ท่อควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซออกซิเจนในเครื่องพีไอซีพีพลังงานต่างๆ	75
5.14	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลาง	
	ท่อควอทซ์ของพลาสมาจากในโตรเจนในเครื่องพีไอซีพีพลังงานต่างๆ	76
5.15	กราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าในวงจรและเวลา	77
5.16	กราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าในวงจรและเวลาหลังจากการปรับ	
	ค่าตัวแปร	77

ป

ถาพที่		หน้า
5.17	กราฟแสดงตำแหน่งของพลาสมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีของพลาสมาจาก	
	ก๊าซอาร์กอนความดัน 2 ปาสคาล จากเครื่องพีไอซีพี ขนาด 1.4 กิโลจูล	78
5.18	กราฟแสดงตำแหน่งของพลาสมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีของพลาสมาจาก	
	ก๊าซอ๊อกซิเจนที่ความดัน 5 ปาสคาล จากเครื่องพีไอซีพี ขนาด 2.4 กิโลจูล	78
5.19	กราฟแสดงตำแหน่งของพลาสมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีของพลาสมาจาก	
	ก๊าซไนโตรเจนที่ความดัน <mark>2 ปาสคาลจาก</mark> เครื่องพีไอซีพี ขนาด 4.32 กิโลจูล	79
5.20	กราฟแสดงความเร <mark>็วเฉลี่ยใน</mark> การเคลื่อ <mark>นที่ของพลา</mark> สมาชีท	
	ระหว่าง3.46 - <mark>2.46 เซนติเม</mark> ตร แ <mark>ละระหว่างช่วง2.4</mark> 6 - 1.46	81
5.21	ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาและความดันของก๊าซทั้งสาม	
	จากเครื่องพี่ไอซีพีขนา <mark>ด 1.4</mark> กิโลจูล	82
5.22	ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาและความดันของก๊าซทั้งสาม	
	จากเครื่องพี่ไอซีพีขนาด 4.32 กิโลจูล	83
5.23	กราฟแสดงคว <mark>ามสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภู</mark> มิอิเล็กตรอนจากเครื่อง	
	พีไอซีพีที่ทำงาน <mark>โดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประ</mark> จุ 1.4 กิโลจูล	84
5.24	กราฟแสดงความสัมพัน <mark>ธ์ระหว่างความดันแ</mark> ละอุณหภูมิอิเล็กตรอนจากเครื่อง	
	พีไอซีพีที่ทำงานโดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 2.4 กิโลจูล	84
5.25	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนจากเครื่อง	
	พีไอซีพีที่ทำงานโดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 4.32 กิโลจูล	85
5.26	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนจากเครื่อง	
	ที่ต้าพินซ์ที่ทำงานโดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 2.4 กิโลจูล	85
5.27	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ	
	พลาสมาจากก๊าซอาร์กอนที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที และเครื่องทีต้าพินช์	86
5.28	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ	
	พลาสมาจากก๊าซไนโตรเจนที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที และเครื่องทีต้าพินช์	86
5.29	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ	
	พลาสมาจากก๊าซอ๊อกซิเจนที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที และเครื่องทีต้าพินช์	87
5.30	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ	
	พลาสมาจากก๊าซอาร์กอนของเครื่องพีไอซีพีที่ได้จากแบบจำลอง	88

ଟ୍ଟି

ภาพที่		หน้า
5.31	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ	
	พลาสมาจากก๊าซออกซิเจนของเครื่องพีไอซีพีที่ได้จากแบบจำลอง	89
5.32	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ	
	พลาสมาจากก๊าซไนโตรเจนของเครื่องพีไอซีพีที่ได้จากแบบจำลอง	89



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของงานวิจัย

โดยทั่วไปคนเราจะรู้จักสสารต่างๆว่ามีอยู่ด้วยกันสามสถานะ คือ สถานะของแข็ง สถานะ ของเหลว และสถานะก๊าซ กล่าวคือ หากสสารหนึ่งๆเริ่มต้นอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อได้รับความ ร้อนปริมาณมากพอ ก็จะเกิดการหลอมละลายและเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลว ซึ่งก็คืออยู่ใน สถานะของเหลว และเมื่อของเหลวยังคงได้รับความร้อนมากพอก็จะกลายเป็นไอ คืออยู่ในสถานะ ก็าซ ซึ่งเป็นสถานะสุดท้ายที่เรารู้จักกันโดยทั่วไป แต่หากก๊าซหรือไอของสสาร ยังคงได้รับพลังงาน เพียงพอ ก๊าซก็จะแตกตัวกลายเป็นประจุ กล่าวคือหากให้พลังงานปริมาณมากพอ สสารสามารถ เปลี่ยนจากสถานะ จากสถานะก๊าซ มาเป็นสถานะก๊าซที่มีประจุไฟฟ้า กลุ่มก๊าซที่มีประจุเหล่านี้ เรียกว่า พลาสมา

พลาสมา คือกลุ่มก๊าซที่ดำรงสภาพมีทั้งอนุภาคที่เป็นประจุบวกหรือไอออน อิเล็กตรอน และอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้า รูปแบบการให้พลังงานแก่สสารเพื่อให้แตกตัวกลายเป็นพลาสมา นั้น สามารถทำได้หลายวิธีการ อาทิเช่น การใช้สนามไฟฟ้า , การใช้คลื่นไมโครเวฟ, การใช้เลเซอร์, และอีกหนึ่งในวิธีการกำเนิดพลาสมาคือการใช้ สนามแม่เหล็ก[1] การที่พลาสมาประกอบด้วย อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ทำให้พลาสมาสามารถนำไฟฟ้าได้ดี และมีอันตรกิริยากับสนามแม่เหล็ก จึง สามารถใช้สนามแม่เหล็กควบคุมทิศการเคลื่อนที่ของพลาสมาได้

เครื่อง ที่ต้าพินซ์ (Theta Pinch) คือเครื่องกำเนิดพลาสมาโดยอาศัยสนามแม่เหล็กและ ควบคุมพลาสมาให้เคลื่อนที่มาบีบอัดกัน (Pinch) จนเกิดเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวซันในห้วงเวลา สั้นๆ แล้วปลดปล่อยรังสีและอนุภาคต่างๆออกมา ในอดีตเครื่อง ที่ต้าพินซ์ จึงถูกใช้ในงาน ศึกษาวิจัยนิวเคลียร์ฟิวซัน ที่ต้าพินซ์เป็นเครื่องกำเนิดและควบคุมพลาสมาที่จัดอยู่ในกลุ่มของ เครื่องลิเนียร์พินซ์ [3] (Linear Pinch Device) ซึ่งเครื่องในกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ แซดพินซ์(Z-Pinch) และ ที่ต้าพินซ์ (Theta-Pinch) โดยชื่อของเครื่องทั้งสอง เรียกตามทิศการ เคลื่อนที่พลาสมาเป็นกระแสพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องตามทิศ Z และทิศ $extbf{0}$ ในระบบพิกัด ทรงกระบอก ตามลำดับ เครื่องทั้งสองถือเป็นต้นแบบของเครื่องกำเนิดนิวเคลียร์ฟิวชั่น ที่ถูก พัฒนาให้มีประสิทธิ์ภาพสูงยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นเครื่องรุ่นต่อๆมาที่มีชื่อคุ้นเคยกันดีได้แก่ เครื่องโทคา มาค (Tokamak) [1,3], เครื่องสเทลลาเรเตอร์ (Stellarator) [1,3], ฯลฯ แต่การใช้งานเครื่อง ที่ต้าพินซ์ มาศึกษาวิจัยควบคุมพลาสมาให้เกิดเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั้น จำเป็นต้องใช้ พลังงานที่สูงมาก ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากพลาสมาที่เครื่องที่ต้าพินซ์สร้างขึ้น โดยการใช้ พลาสมาที่อยู่ในช่วงกำลังถูกบีบอัดแต่ไม่ถึงกับหลอมรวมกันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน กล่าวคือไม่เกิดการ พินซ์ มาใช้กับงานหลายด้าน และกระบวนการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ พลังงานมากเท่ากับกระบวนการเกิดนิวเคลียร์ฟิวชั่น จึงสามารถเรียกเครื่องกำเนิดพลาสมาโดย อาศัยสนามแม่เหล็ก และควบคุมพลาสมาให้เคลื่อนที่วนเป็นกระแสตามทิศ Θ แล้วบีบเข้ามาตาม แนวรัศมี แต่ไม่เกิดการพินซ์นี้ว่า เครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดกู่ควบเหนี่ยวนำ (PULSED INDUCTIVELY COUPLED PLASMA DEVICE: PICP) หรือ พีไอซีพี

ปัจจุบัน มีการนำ เครื่องที่ต้าพินซ์หรือเครื่องพีไอซีพี มาปรับปรุง ไปใช้ในการศึกษาวิจัย หลายด้าน อาทิเช่น ใช้ในการทำฟิล์มบาง ,เคลือบผิวหน้าวัสดุ และโดยเฉพาะการนำมาใช้งาน ด้าน การปรับปรุงพื้นผิววัสดุ [2] โดยการเพิ่มหมู่ฟังชันก์บางชนิดที่พื้นผิวของวัสดุ (surface functional group) เพื่อให้วัสดุมีสมบัติที่ดีขึ้น ซึ่งเครื่องชนิดนี้ยังเหมาะกับการปรับปรุงสภาพ พื้นผิวของวัสดุที่ไม่ทนความร้อน เนื่องจากพลาสมาที่เกิดจากเครื่องชนิดนี้มีทิศทางพุ่งเข้ามาตาม แนวรัศมีที่แน่นอน พลาสมาจึงสามารถลงไปเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุลที่ผิววัสดุเป็นหมู่ฟังชันก์ ใหม่ได้ลึกกว่าพลาสมาที่เกิดจากเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบต่อเนื่องทั่วไป และกระบวนการ ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมาก จึงไม่เกิดการสะสมของความร้อนที่มากเกินไปบนพื้นผิววัสดุ

จะเห็นว่าเครื่องพีไอซีพีสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน แต่ยังคงต้องใช้พลังงานที่สูง ในการกำเนิดพลาสมา ซึ่งถือเป็นข้อด้อยของเครื่องชนิดนี้และเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้งานด้าน ต่างๆรวมถึงใช้งานในระดับอุตสาหกรรม จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพีไอซีพีที่สามารถทำงานได้ โดยใช้พลังงานที่น้อยลง แต่การสร้างเครื่องพีไอซีพีที่มีตัวแปรต่างๆแตกต่างจากเครื่องทีต้าพิ้นช์นั้น ย่อมส่งผลทำให้สมบัติเครื่อง และสมบติของพลาสมาจากเครื่อง นั้นแตกต่างกันด้วย และความรู้ที่ ได้รับยังเป็นพื้นฐานที่มีประโยชน์ในการพัฒนา และศึกษาเครื่องกำเนิดปฏิกิริยาฟิวชันในอนาคต

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบและสร้างเครื่องพีไอซีพี แล้วศึกษาสมบัติของ เครื่องและสมบัติของพลาสมาที่กำเนิดจากเครื่องที่สร้างขึ้น โดยในวิทยานิพนธ์นี้จะทำการสร้าง อุปกรณ์ในการวัดสมบัติของเครื่องพีไอซีพีได้แก่ ขดลวดโรโกวสกี้ (Rogowski Coil)เพื่อวัดกระแสที่ ไหลภายในเครื่องพีไอซีพี และทำการสร้างหัววัดสนามแม่เหล็ก (Magnetic Probe) เพื่อวัดการ เคลื่อนที่ของพลาสมา และใช้สเปคโตรมิเตอร์ (Optical Emission Spectrometer) เพื่อวัดอุณหภูมิ อิเล็กตรอน ผลที่ได้จากการวัดการเคลื่อนที่ของพลาสมาจะถูกนำไปใช้ร่วมกับผลที่ได้จาก แบบจำลองทางทฤษฎี และเปรียบเทียบกับผลจากเครื่องที่ต้าพินช์ที่วัดด้วยวิธีการเดียวกัน ข้อมูล ต่างๆที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการนำเครื่องพีไอซีพีไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

- 1. ออกแบบและสร้างเครื่องพีไอซีพี
- ศึกษาสมบัติของเครื่องและสมบัติของพลาสมาที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที่สร้างขึ้น
- เปรียบเทียบแนวโน้มของสมบัติพลาสมากับแบบจำลองทางทฤษฏี และเปรียบเทียบกับ สมบัติดังกล่าวที่ได้จากเครื่องที่ต้าพินช์ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานในการ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเครื่องพีไอซีพี ไปใช้กับงานวิจัยด้านอื่นๆต่อไป

1.3 วิธีการดำเนินการวิ<mark>จัย</mark>

ศึกษากระบวนการเกิดพลาสมาและหลักการทำงานต่างๆของเครื่องพีไอซีพี แล้วทำการ ออกแบบและสร้างเครื่องพีไอซีพี จากนั้นศึกษาสมบัติของเครื่องที่สร้างขึ้นโดยทำการสร้าง ขดลวดโลโกวสกี้ เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในเครื่อง และศึกษาสมบัติของพลาสมาจากเครื่อง พีไอซีพี โดยทำการสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กเพื่อวัดการเคลื่อนที่ของพลาสมาภายในเครื่อง และ ใช้สเปคโตรมิเตอร์เพื่อหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอน ศึกษาแบบจำลองทางทฤษฎี แล้วหาสมบัติของ พลาสมาจากการคำนวณโดยวิธีการเชิงตัวเลขตามแบบจำลองทางทฤษฎี แล้วเปรียบเทียบกับผล การหาสมบัติของเครื่องและสมบัติของพลาสมาที่ศึกษาด้วยวิธีการเดียวกันจากเครื่องที่ต้าพินช์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้เครื่อง PICP ที่สามารถกำเนิดพลาสมา โดยใช้พลังงาน1.4 kJ.

2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องพีไอซีพี รวมถึงกระบวนการเกิดและ สมบัติของพลาสมา ภายในเครื่อง และได้องค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา เครื่องพีไอซีพี และประยุกต์เครื่องพีไอซีพีไปใช้กับงานวิจัยด้านอื่นๆต่อไป

3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดที่ใช้วัดสมบัติของเครื่อง และสมบัติของพลาสมาที่เกิด ภายในเครื่องพีไอซีพี

1.5 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลงานวิจัย

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 บท โดยในบทที่1 ได้กล่าวถึง แนวเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เป็นการกล่าวถึงเครื่องพีไอ ซีพีซึ่งใช้เครื่องที่ต้าพินซ์เป็นต้นแบบในการสร้าง บทที่ 3 เป็นส่วนของแบบจำลองทางทฤษฏีซึ่งจะ เป็น แบบจำลองทางทฤษฏีของวงจรเครื่อง พีไอซีพี และแบบจำลองทางทฤษฏีการเคลื่อนที่ของ กระแสพลาสมา บทที่ 4 เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องพีไอซีพี ในบทนี้จะแบ่งเป็นส่วนของการ สร้างส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพีไอซีพี และส่วนของเครื่องมือวัดรวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือวัด ในการทดลอง บทที่ 5 เป็นส่วนของผลการทดลอง โดยจะแสดงผลการทดลองหาสมบัติของเครื่อง และสมบัติของพลาสมาจากเครื่องพีไอซีพีร่วมกับผลที่ได้จากเครื่องที่ต้าพิ้นซ์เพื่อเปรียบเทียบกัน และบทที่ 6 เป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2 เครื่องพีไอซีพี

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้คือ การออกแบบและการสร้าง เครื่องกำเนิดพลาสมา แบบห้วง ชนิด ควบคู่เหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูล หรือเครื่องพีไอซีพีที่สามารถกำเนิดพลาสมาด้วยพลังงานที่เก็บ สะสมในตัวเก็บประจุขนาด 1.4 กิโลจูล การสร้างเครื่องพีไอซีพีในวิทยานิพนธนี้ได้ใช้เครื่อง ที่ต้าพินซ์เป็นต้นแบบ จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงาน กระบวนการเกิดพลาสมา รวมถึงอุปกรณ์สำคัญต่างๆในเครื่องที่ต้าพินซ์ บทนี้จึงขอกล่าวถึงส่วนประกอบและการทำงานของ พีไอซีพีซึ่งจะอุปกรณ์หลักเช่นเดียวกับเครื่องที่ต้าพินซ์ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักคือ ส่วนประกอบหลักของเครื่องพีไอซีพี กระบวนการเกิดพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพีและเครื่อง ที่ต้าพินซ์ และอุปกรณ์หลักของเครื่องพีไอซีพี

2.1 ส่วนประกอบของพี่ไอซีพี

เครื่องพีไอซีพีมีส่วนประกอบหลักเช่นเดียวกับเครื่องที่ต้าพินซ์ โดยเครื่องที่ต้าพินซ์ที่ใช้เป็น ต้นแบบเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน อยู่ที่กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่น ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องที่ได้รับมอบจาก Asian African Association for Plasma Training (AAAPT) มีลักษณะดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ภาพเครื่องที่ต้ำพินซ์[1]

การทำงานของเครื่องพีไอซีพีเพื่อกำเนิดพลาสมาประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆคือ

1ส่วนเก็บสะสมประจุ ประกอบด้วยเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง(High Voltage Charger) และตัวเก็บประจุความจุสูง(Capacitor Bank)

2 ส่วนควบคุมการปล่อยประจุ ประกอบด้วย สปาร์คแก๊ปสวิทช์(Spark Gap Switch)และ

อิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์(Electronics Trigger)

- 3 ส่วนที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ประกอบด้วย ขดลวดรอบเดียว(Single Turn Coil)
- 4 ส่วนระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ภาชนะสุญญากาศคือ ท่อควอทซ์(Quartz Tube) และปั้มสุญญากาศ(Vacuum Pump)

ส่วนประกอบต่างๆเขียนเป็นแผนผังดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แผนภาพแสดงส่วนประกอบของเครื่องพีไอซีพี

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องพีไอซีพีเริ่มต้นจาก ทำการเก็บประจุ ด้วยเครื่องซาร์จประจุ ความต่างศักย์สูงซาร์จประจุมาเก็บสะสมไว้ในตัวเก็บประจุความจุสูง หลังจากนั้นทำการปล่อย ประจุโดยจ่ายสัญญาณแบบห้วงจากอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์ไปยังสปร์คแก๊ปสวิทซ์ ทำให้ประจุไหล ออกจากตัวเก็บประจุผ่านสปาร์คแก๊บสวิทซ์ในครั้งเดียว ประจุจำนวนมหาศาลที่ถูกปล่อยจากตัว เก็บประจุความจุสูงในช่วงเวลาสั้นๆ จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงไหลผ่านสปาร์คแก๊ปสวิทช์ ไปยังขดลวดรอบเดียวและเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ก๊าซในภาชนะสุญญากาศก็จะแตก ตัวกลายเป็นพลาสมา

2.2 กระบวนการเกิดพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพีและเครื่องทีต้าพินซ์

พลาสมาที่เกิดขึ้นภายในเครื่องพีไอซีพีจะถูกบีบอัดด้วยแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่ถูก เหนี่ยวนำจากกระแสไฟฟ้า ขั้นตอนเกิดและบีบอัดพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพีอย่างละเอียด แสดงดังรูปที่ 2.3



ลำดับขั้นการเกิดพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพีเริ่มจากรูป ก ,รูป ข, รูป ค และรูป ง ตามลำดับดังนี้

รูป ก แสดงภาคตัดขวางของขดลวดรอบเดียว และท่อควอทซ์ ซึ่งภายในท่อควอทซ์ถูกดูด อากาศออกให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศและใส่ก๊าซที่ต้องการทำให้เกิดพลาสมา **รูป ข** เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกปล่อยผ่านสปาร์คแก๊ปสวิทซ์เข้ามายังขดลวดรอบเดียว ก็จะ เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

ร**ูป ค** ตามกฏของเลนส์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กภายในระบบ ระบบจะ ปรับตัวเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยก๊าซในภาชนะสุญญากาศจะแตกตัวเป็นพลาสมาและ ฟอร์มตัวเป็นกระแสพลาสมา หากกระแสไฟฟ้าภายนอกเพิ่มขึ้น กระแสพลาสมาจะไหลวนในทิศ ตรงข้ามกับกระแสภายนอก เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กต้านสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแส ภายนอก

ร**ูป ง** กระแสพลาสมา เมื่อเคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสภายนอกก็จะ เกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก (แรงลอเรนต์) กระทำให้เคลื่อนที่เข้ามาตามแนวรัศมี แต่หาก พลังงานมากพอ พลาสมาจะเคลื่อนที่เข้ามาจนหลอมรวมที่จุดศูนย์กลาง เรียกว่าเกิดการ พินซ์ ซึ่ง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดภายในเครื่องที่ต้าพินซ์

การที่พลาสมาถูกบีบเข้ามาได้ลึกเท่าไร หรือจนมาหลอมรวมกันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิว ขันได้นั้นต้องอาศัยสนามแม่เหล็กความเข้มสูงซึ่งแปรผันโดยตรงกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลใน ขดลวดรอบเดียว จึงต้องทำการสะสมประจุจนมีปริมาณสูงแล้วปล่อยออกมาในทีเดียว เพื่อให้ได้ กระแสไฟฟ้าปริมาณสูงออกมาเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงนั่นเอง หากมองใน ระบบพิกัดทรงกระบอก จะเห็นว่า กระแสพลาสมาที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ในทิศ **0** และเป็นที่มาในการ เรียกเครื่องกำเนิดพลาสมาชนิดนี้ว่า ที่ต้าพินซ์ พิจารณาได้จากรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แผนภาพแสดงทิศทางกระแสไฟฟ้า กระแสพลาสมา และสนามแม่เหล็ก

2.3 อุปกรณ์สำคัญของเครื่องพีไอซีพี

2.3.1 ตัวเก็บประจุความจุสูงและเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง

ตัวเก็บประจุความจุสูงคือ ส่วนเก็บประจุพีไอซีพี เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงออกมา เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก สำหรับตัวเก็บประจุความจุสูงที่จะใช้กับเครื่องพีไอซีพีเป็นตัวเก็บ ประจุขนาด 30 ไมโครฟารัด ที่สามารถรับความต่างศักย์ในการชาร์จประจุได้ 20 กิโลโวลต์ 2 ตัวต่อ ขนานกันรวมเป็น 60 ไมโครฟารัด ขณะที่ตัวเก็บประจุความจุสูงของเครื่องที่ต้าพินซ์มีขนาด 4 ไม โครฟารัด ที่สามารถรับความต่างศักย์ในการชาร์จประจุได้ถึง 40 กิโลโวลต์ จำนวน 3 ตัวต่อกัน แบบขนานรวมเป็น12 ไมโครฟารัด ดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.5 ภาพของตัวเก็บประจุความจุสูงของพีไอซีพี(ซ้าย) และเครื่องที่ต้าพินช์(ขวา)[1]



ตัวเก็บประจุความจุสูงนี้จะถูกชาร์จประจุด้วย เครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง สำหรับ เครื่องที่ต้าพินซ์ ทำการ ชาร์จตัวเก็บประจุความจุสูง จนมีความต่างศักย์สูงสุดที่ 20 กิโลโวลต์ แต่ สำหรับเครื่องพีไอซีพีจะออกแบบให้สามารถ ชาร์จตัวเก็บประจุความจุสูง จนมีความต่างศักย์สูงสุด ไม่เกิน 18 กิโลโวลต์เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเก็บประจุของเครื่องพีไอซีพี วงจรของ เครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูงแสดงดังรูปที่ 2.7



รูปที่2.7 เป็นวงจรอย่างง่ายของ เครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง จากเครื่องที่ต้าพินช์ ประกอบด้วย ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Variac) ใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ให้กับตัวแปลงไฟฟ้า ความต่างศักย์สูง (High Voltage Transformer) เมื่อทำการชาร์จกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไดโอด และตัวต้านทานขนาด 10 เมกะโอมห์ เข้าสู่ตัวเก็บประจุความจุสูง โดยจะมีสวิทซ์ฉุกเฉิน หรือดัมพ์ สวิทซ์ (S) ไว้กดเพื่อให้ประจุจากตัวเก็บประจุความจุสูงสามารถคายประจุผ่านตัวต้านทาน 30 เม กะโอมห์ ลงสู่พื้นดินได้หากมีเหตุฉุกเฉิน

2.3.2 สปาร์คแก๊ปสวิทช์ และอิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์

อิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์เป็นตัวจ่ายสัญญาณให้แก่สปาร์คแก็ปสวิทซ์ เพื่อให้ประจุสามารถ ใหลออกตัวเก็บประจุความจุสูงไปยังขดลวดรอบเดียวได้ สัญญาณที่จ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าห้วงสั้นๆ ซึ่งจะจ่ายผ่านหม้อแปลงเพื่อให้มีศักย์ไฟฟ้ามีค่าสูงขึ้นจ่ายมายังสปาร์คแก๊ปสวิทซ์

สปาร์คแก๊ปสวิทซ์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเครื่องพีไอซีพี ทำงานสลับกับเครื่องชาร์จ ประจุความต่างศักย์สูง โดยเราจะหยุดทำการชาร์จประจุ เมื่อประจุที่ตัวเก็บประจุความจุสูงถูก สะสมมาถึงความต่างศักย์ที่ต้องการ จากนั้นเมื่อสปาร์คแก๊บทำงานจะเป็นตัวเชื่อมวงจรระหว่างตัว เก็บประจุความจุสูงกับขดลวดรอบเดียวให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสูงขดลวดรอบเดียวเพื่อ เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก สปาร์คแก๊ปสวิทซ์ในเครื่องที่ต้าพินซ์ ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้ว ขั้วหนึ่งต่ออยู่กับตัวเก็บประจุควมจุสูง และอีกขั้วหนึ่งต่ออยู่กับขดลวดรอบเดียว มีแผ่นเหล็กอยู่ ตรงกลาง ส่วนที่เป็นฉนวนทำขึ้นจาก ในลอน -6 มีลักษณะดังรูปที่ 2.8 และการต่อสปาร์คแก๊ปเข้า กับอิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์และวงจรของเครื่องแสดงดังรูปที่2.9





รูปที่ 2.9 แผนภ<mark>าพแสดงการต่อสปาร์คแก๊บสวิทช์เข้ากับว</mark>งจรของเครื่องที่ต้าพินซ์

ในรูปที่2.9 ขณะที่สปาร์คแก๊บยังไม่ได้รับสัญญาณจากอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์ สปาร์คแก๊ป จะเป็นตัวเปิดวงจรระหว่างตัวเก็บประจุความจุสูงและขดลวดรอบเดียว ทำให้สามารถชาร์จประจุ มาสะสมที่ตัวเก็บประจุได้โดยไม่ไหลลงกราวน์ด้านขดลวดรอบเดียว เมื่อหยุดการชาร์จ ความต่าง ศักย์เนื่องจากประจุที่สะสมอยู่ที่ตัวเก็บประจุยังไม่มากพอ ที่ประจุสามารถกระโดดเข้าสู่ขดลวด รอบเดียวได้โดยตรง จนเมื่อมีการจ่ายสัญญาณจากอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์ ทำให้แผ่นเหล็กและขั้ว ด้านขดลวดรอบเดียวมีศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้น ประจุจากตัวเก็บประจุความจุสูงก็จะสามารถไหลผ่านส ปาร์คแก๊ปเข้าสู่ขดลวดรอบเดียวได้ สัญญาณที่จ่ายจากอิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์เป็นสัญญาณห้วง สั้นๆ ประจุในตัวเก็บประจุความจุสูงก็จะถูกปล่อยจากตัวเก็บประจุเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าปริมาณ สูงไหลเข้าสู่ขดลวดรอบเดียวไปเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้

2.3.3 ขดลวดรอบเดียว

ขดลวดรอบเดียวเป็นส่วนที่เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งขดลวดรอบเดียวของเครื่อง พีไอซีพีจะออกแบบลักษณะเดียวกับเครื่องทีต้าพินซ์เนื่องจากมีความสะดวกในการติดตั้ง โดย ขดลวดรอบเดียวของเครื่องทีต้าพินซ์ทำขึ้นจากอลูมิเนียม มีจำนวน 8 ชิ้นต่อเรียงกันแบบขนาน มี ลักษณะดังรูป 2.10



รูปที่ 2.10 แบบร่างแสดงขนาดของขดลวดรอบเดียว[1]

2.3.4 ท่อควอทซ์และปั้มสุญญากาศ

เครื่องที่ต้าพินซ์ ใช้ ท่อควอทซ์ เป็นภาชนะสุญญากาศ เป็นส่วนที่ใช้บรรจุก๊าซเพื่อสร้าง พลาสมา ซึ่งอยู่ภายในขดลวดรอบเดียว ท่อควอทซ์ ที่ใช้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร และมี ความยาว 120 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 2.11 ปลายทั้งสองด้านของท่อควอทซ์ต่อกับตัวสวมที่ทำ มาปิดเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆแสดงเป็นแผนภาพดังรูปที่2.12

ปั้มสุญญากาศที่ใช้กับเครื่องที่ต้าพินซ์ มีอยู่ 2 แบบคือ ดิฟฟิวชันปั้ม และปั้มแบบโรตารี่ ซึ่งจะต่ออยู่กับตัวสวมที่ปลายท่อควอทซ์ตามลำดับ ปั้มสุญญากาศ แบบโรตารี่ จะทำหน้าที่ดูด อากาศภายในท่อควอทซ์ตั้งแต่ที่ความดันบรรยากาศจนถึง 1 -2 ปาสคาล จากนั้นดิฟฟิวชันปั้มเริ่ม ทำงานร่วมกับ ปั้มสุญญากาศ แบบโรตารี่ ตั้งแต่ความดัน 1-2 ปาสคาล ลงไปจนถึงค วามดัน 5.5×10⁻³ ปาสคาล ซึ่งเป็นความดันต่ำสุดที่ดิฟฟิวชันปั้มสามารถทำได้



รูปที่2.12 แผนภาพแสดงการต่อท่อควอทซ์เข้ากับอุปกรณ์ต่าง

สำหรับก่อนการใช้งานเครื่องทีตาพินซ์ ต้องมีการเตรียมเครื่องทีตาพินซ์เพื่อใช้งาน โดย เริ่มจากการเปิดปั้มสุญญากาศแบบโรตารี่เพื่อปั้มอากาศออกจากดิฟฟิวชันปั้มและท่อควอทซ์ ซึ่ง ในการปั้มอากาศออกจากระบบนั้น ปั้มสุญญากาศแบบโรตารี่ทำการดูดอากาศออกจากท่อ ควอทซ์ผ่านทางดิฟฟิวชัน จนมีความดันประมาณ 1-2 ปาสคาล จากนั้น ทำการปิดวาล์วที่กั้น ระหว่างท่อควอทซ์ และดิฟฟิวชันปั้ม แล้วทำการเปิดดิฟฟิวชันปั้มให้ทำงาน โดยดิฟฟิวชันปั้มใช้ เวลาประมาณ 20 นาที จึงเริ่มให้ดิฟฟิวชันปั้มทำงาน ร่วมกับปั้มสุญญากาศแบบโรตารี่ โดยการ เปิดวาล์วที่กั้นระหว่างท่อควอทซ์และดิฟฟิวชันปั้ม ให้ปั๊มทำงานร่วมกันตั้งแต่ความดันประมาณ 1-2 ปาสคาล จนถึงความดันต่ำสุด จากนั้นทำการใส่ก๊าซที่ต้องการใช้ในการทดลองเข้าไปและปรับ ความดันให้อยู่ในระดับที่ กำหนดเพื่อทำการทดลอง สำหรับเครื่องพีไอซีพีที่จะทำการสร้างขึ้นใช้ เพียงปั้มสุญญากาศแบบโรตารี่ซึ่งไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากดังเช่นเครื่องทีต้าพินซ์ แต่ความดันต่ำสุด ก็ไม่สามารถทำได้เท่ากับเครื่องทีต้าพินซ์จึงต้องมีการออกแบบภาชนะสุญญากาศเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการรั่วน้อยที่สุด

การใช้งานเครื่องทีตาพินซ์เริ่มจาก ทำการตั้งค่าความต่างศักย์ของเครื่องชาร์จประจุความ ต่างศักย์สูงเพื่อใช้ในการชาร์จประจุให้กับตัวเก็บประจุความจุสูง จากนั้นทำการกดสวิตซ์เปิดให้ เครื่องชาร์จ ชาร์จตัวเก็บประจุความจุสูง และกดสวิทช์หยุดเมื่อความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บ ประจุความจุสูงถึงระดับที่ต้องการ กดสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่สปาร์ค แก็ปสวิทช์ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าจากตัวเก็บประจุความจุสูงไหลเข้ามาที่ขดลวดรอบเดียว ก๊าซที่อยู่ ภายในท่อควอทซ์ก็จะแตกตัวเป็นพลาสมา

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3 แบบจำลองทางทฤษฎีของการแผ่รังสีและการเคลื่อนที่ของพลาสมา

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องพีไอซีพีแล้วศึกษาสมบัติของ พลาสมาที่ได้จากเครื่องที่สร้างขึ้น ดังนั้นการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพลาสมาจึงทีความสำคัญ อย่างยิ่ง การทำงานของเครื่องพีไอซีพีเริ่มจากทำการชาร์จประจุมาเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุความจุสูง จากนั้นปล่อยประจุออกมาจากตัวเก็บประจุในครั้งเดียว เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าปริมาณสูงไหลผ่าน ขดลวดรอบเดียวทำให้เกิดสนามแม่เหล็กภายในท่อควอทซ์ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเหนี่ยวนำให้ เกิดกระแสพลาสมาไหลวนในทิศทางตรงข้ามกับกระแสภายนอกที่ไหลภายในวงจรของเครื่องพีไอ ซีพี และการเคลื่อนที่ของพลาสมาเป็นกระแสพลาสมานั้นทำให้เกิดแรงลอเรนซ์ บีบให้เข้ามาตาม แนวรัศมี

ค่าของกระแสไฟฟ้า ที่ออกจากตัวเก็บประจุแล้ว ใหลในวงจรเครื่อง พีไอซีพี ค่าของ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าที่ใหลผ่านขดลวดแบบรอบเดียว แล ะ สมบัติของพลาสมาอาทิเช่นพลังงานของพลาสมาและความเร็วของพลาสมาล้วนมี ความสัมพันธ์ กัน การ เคลื่อนที่ กระแสพลาสมา เข้ามาตามแนวรัศมี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการทราบ การ เปลี่ยนแปลงระหว่างค่าของกระแสไฟฟ้าที่ใหลในเครื่องและ การเคลื่อนที่กระแสพลาสมาที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ ของ การเปลี่ยนแปลงของค่า กระแสไฟฟ้าในวงจร ของเครื่องพีไอซีพี และการเปลี่ยนแปลง สมบัติของ พลาสมาที่เกิดขึ้น ใน วิทยานิพนธ์นี้จึงได้เสนอแบบจำลองทางทฤษฎีสำหรับใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์และการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยแบ่งแบบจำลองออกเป็น 2 แบบ ที่ต้องใช้ร่วมกัน คือ แบบจำลองทาง ทฤษฎีของวงจรเครื่อง พีไอซีพี และแบบจำลองทางทฤษฎีของการเคลื่อนที่ของกระแสพลาสมา แล้วนำผลที่ได้จากแบบจำลองทางทฤษฎีมาวิเคราะห์ร่วมผลที่ได้จากการทดลอง

เราสามารถสังเกตุเห็นพลาสมาจากแสงที่แผ่ออกมา ซึ่งก็คือโฟตอนที่แผ่มาจากพลาสมา เนื่องมาจากอันตรกิริยาต่างๆระหว่างอิเล็กตรอนกับอนุภาคภายในพลาสมาทำให้อิเล็กตรอน ปลดปล่อยโฟตอนออกมา แสงที่แผ่ออกมาจากพลาสมาสามารถนำมาวิเคราะห์หาอุณหภูมิ อิเล็กตรอนซึ่งถือเสมือนเป็นพลังงานของพลาสมาโดยรวม [3] จึงขออธิบายถึงแบบจำลองการแผ่ รังสีก่อน ที่เราจะไปศึกษาแบบจำลองทางทฤษฎีของวงจรของเครื่องพีไอซีพี และของเคลื่อนที่ของ พลาสมาในลำดับถัดไป

3.1 แบบจำลองการแผ่รังสีของพลาสมา

พลาสมาเป็นกลุ่มก๊าซที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอน ไอออน และอนุภาคที่เป็นกลางทาง ไฟฟ้า แทบจะทั้งหมดของอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการชนกันระหว่าง อิเล็กตรอนกับไอออนหรือกับอะตอมที่เป็นกลาง [7] ซึ่งทำให้เกิดเป็นปรากฏการต่างๆ บาง ปรากฏการณ์ทำให้เกิดการปลดปล่อยโฟตอนที่มีระดับพลังงานต่างๆ อาจจะตั้งแต่เป็นสเป็คตรัม ในช่วงที่ตามองเห็น(Visible light) ไปจนถึง รังสีแกมมา(Gamma Ray) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของ พลาสมา การที่พลาสมาปลดปล่อยโฟตอนออกมานี้เรียกว่า การแผ่รังสีของพลาสมา หรืออาจ นิยามสั้นๆว่าการที่อิเล็กตรอนปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการแผ่รังสี ของพลาสมาที่พิจารณาแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ การแผ่รังสีแบบเบรมสตาลุง (Bremsstrahlung) การแผ่รังสีแบบรีคอมบิเนซัน (recombination radiation) กระบวนการแผ่รังสีแบบเส้น (line radiation)[7] สำหรับกระบวนการต่างๆ สามารถอธิบายดังต่อไปนี้

การแผ่รังสีแบบเบรมสตาลุง (Bremsstrahlung) เป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นเมื่อ อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ผ่านนิวเคลียสของอะตอมหรือไอออนแล้ว สูญเสียพลังงานจลน์ภายใต้ อิทธิพลของสนามไฟฟ้าจากนิวเคลียส อิเล็กตรอนอิสระปลดปล่อยพลังงานออกมา ภายหลัง อันตรกิริยานี้อิเล็กตรอนยังคงอยู่ในสถานะอิเล็กตรอนอิสระ จึงเรียกกระบวนการแผ่รังสีแบบนี้ว่า กระบวนการฟรี - ฟรี แทรนซิชัน (free – free transition)[5] รังสีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้มี ความยาวคลื่นต่อเนื่อง

การแผ่รังสีแบบรีคอมบิเนชัน (recombination radiation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ อิเล็กตรอนอิสระเข้าชนกับอะตอมหรือไอออนแล้วถูกจับให้มาอยู่ในระดับชั้นพลังงาน ของอะตอม จึงเรียกกระบวนการนี้ว่า กระบวนการฟรี - บาวน์ด แทรนซิชัน (free - bound transition) ผลก็คือ อิเล็กตรอน จะปลดปล่อยโฟตอนพลังงานออกมา พลังงานของโฟตอนขึ้นอยู่กับพลังงานของ อิเล็กตรอนเดิมที่เข้ามา รังสีที่เกิดจากกระบวนการนี้มีความยาวคลื่นต่อเนื่อง

กระบวนการแผ่รังสีแบบเส้น (line radiation) เป็นกระบวนการแผ่รังสีที่เกิดขึ้นหลังจาก อะตอมหรือไอออนถูกชนด้วยอิเล็กตรอน แล้วกระตุ้นไปให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการ เปลี่ยนสถานะที่ระดับชั้นพลังงานต่ำไปสู่ระดับชั้นซึ่งมีพลังงานสูง และเมื่ออิเล็กตรอนกลับมายัง ระดับพลังงานเดิมก็จะปลดปล่อยโฟตอนออกมา จึงเรียกกระบวนการแผ่รังสีแบบนี้ว่า กระบวนการบาวน์ด – บาวน์ด แทรนซิชัน (bound – bound transition) พลังงานของโฟตอนจึง ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสองระดับชั้นพลังงาน โฟตอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจึงมีพลังงานที่ กระจาย และเป็นที่มาในการเรียกการแผ่รังสีแบบนี้ว่า กระบวนการแผ่รังสีแบบเส้น (line radiation) [6]

สำหรับการแผ่รังสีในแต่ละกระบวนการ สามารถคำนวณหาพลังงานได้ดังสมการที่ 3.1, 3.2, 3.3[14]

ความหนาแน่นกำลังของการแผ่รังสีแบบเบรมสตาลุง(Power density of Bremsstrahlung: $P_{\scriptscriptstyle B}$)

$$P_{B} \approx \frac{64}{3} (\frac{\pi}{3})^{\frac{1}{2}} (\alpha a_{o})^{3} (\frac{kT}{E_{H}})^{\frac{1}{2}} \frac{E_{H}^{2}}{\hbar} (Zeff)^{2} N_{i} N_{e}$$
 $\tilde{\sigma} \sigma \delta / \eta_{0} \eta_$

ความหนาแน่นกำลังของก<mark>าร</mark>แผ่รังสีแบบรีคอมบิเนชัน(Power density of recombination: *P_R*)

$$P_{R} \approx \frac{64}{3} (\frac{\pi}{3})^{\frac{1}{2}} (\alpha a_{o})^{3} (\frac{E_{H}}{kT})^{\frac{1}{2}} \frac{E_{H} E_{\infty}}{\hbar} (Z_{n})^{2} N_{i} N_{e} \qquad \tilde{\sigma} \sigma \sigma / \tilde{\sigma} / \tilde{\sigma}_{n} \tilde{\sigma}$$

ความหนาแน่นกำลังของการแผ่รังสีแบบเส้น(Power density of line radiation: $P_{_L}$)

$$P_{L} \approx 32\pi (\frac{\pi}{3})^{\frac{1}{2}} (\frac{E_{H}}{kT})^{\frac{1}{2}} \frac{E_{H}^{2}}{\hbar} (\sum_{m} \overline{g} f_{mn} \exp(-\frac{E_{mn}}{kT})) a_{o}^{3} N_{i} N_{e}$$
 วัตต์/ลูกบาศก์เมตร 3.3

เมื่อกำหนดให้

- *E_H* คือ พลังงานไอออนใน เซชันของอะตอมไฮโดรเจน (ionization energy of hydrogen)
- E_{∞} คือ พลังงานไอออในเซชัน (ionization energy)
- E_{mn} คือ ผลต่างของพลังงานระหว่างสถานะ m กับ n
- $f_{\scriptscriptstyle mn}$ คือ ความแรงออสซิลเลเตอร์การปล่อยรังสี (emission oscillator strength)
- N_e คือ เลขความหนาแน่นอิเล็กตรอน (number of electron

density)

- N_i คือ เลขความหนาแน่นไอออน (number of ion density)
- α คือ ค่าคงที่โครงสร้างรายละเอียด (fine structure constant)
- a_o คือ รัศมีของโบร์ (Bohr radius)
- k คือ ค่าคงที่ของโบลซ์มันน์ (Boltzmann s' factor)
- Zeff คือ ค่าประจุยังผล (effective charge)
 - Z ก็อ เลขอะตอม (atomic number)
 - \overline{g} คือ ค่ายังผลกันท์ (effective gaunt factor)
 - T คือ อุณหภูมิของพลาสมาในหน่วยเคลวิน (plasma temperature: Kelvin)

เราสามารถคำนวณหาพลังงานของพลาสมาโดยการวิเคราะห์ รังสีที่แผ่ออกมาจาก พลาสมา โดยอาศัย แบบจำลองสมดุลอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่ (local thermodynamics equilibrium model) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.1 แบบจำลองสมดุลอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่ (local thermodynamics equilibrium model)

หากพลาสมามีความเป็นเนื้อเดียว (homogeneous) รวมถึงมีสมดุลอุณหพลศาสตร์ แล้ว ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะสามารถอธิบายได้โดยง่าย แต่ในความเป็นจริงความหนาแน่นของ พลาสมาไม่ได้สม่ำเสมออย่างสมบูรณ์ ดังนั้นแบบจำลอง สมดุลอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่ นี้ จึง ทำการศึกษาพลาสมาเฉพาะที่โดยการแบ่งปริมาตรของพลาสมาทั้งหมดให้มีขนาดเล็กและสมมติ ให้พลาสมาภายในปริมาตรเล็กๆ นั้นมีความเป็นเนื้อเดียว และมีสมดุลอุณหพลศาสตร์ โดยขนาด ของปริมาตรที่ถูกแบ่งนี้มีค่ามากกว่าค่า มีน-พรี-พาท (mean free path)ของอนุภาคในพลาสมา หรือโฟตอน

กำหนดให้ทุกอิเล็กตรอนอยู่ในสถานะพื้น (ground state)ของตัวเอง อัตราส่วนของความ หนาแน่นไอออนของสองสถานะที่มีสถานะไอออนิกถัดกัน (i และ i+1) สามารถแทนด้วย สมการ ซาฮา (Saha Equation)[7] ดังนี้

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2}{N_e} \left(\frac{U_{i+1}}{U_i} \right) \left(\frac{2\pi m_e k T_e}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{\chi}{k T_e} \right)$$

$$3.4$$

เมื่อ

 N_{i+1} คือ ความหนาแน่นของไอออนที่สถานะ i+1

N_i คือ ความหนาแน่นของไอออนที่สถานะ *i*

- U_i คือ พาร์ทิชัน ฟังก์ชัน(partition function)ของไอออนสถานะ i
- χ_i คือ ศักย์ไอออนไนเซชันของไอออนในสถานะ i (ionization potential of ith ion)
- T_e คือ อุณหภูมิอิเล็กตรอนในหน่วยอิเล็กตรอนโวลท์(electron temperature)
- E_i คือ ศักย์ไอออนไนเซชันของไอออนในสถานะไอออนที่ iไปสู่สถานะที่ i+1
- $N_{\scriptscriptstyle e}$ คือ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน

การกระจายตัวความหนาแน่นของไอออนที่มีสถานะพื้นด้วยกัน สามารถแทนด้วย ความสัมพันธ์แบบโบทซ์มาน (Boltzmann relation) ดังสมการ

$$\frac{N(p)}{N(q)} = \frac{g_p}{g_q} \exp\left(-\frac{E_p - E_q}{kT_e}\right)$$
3.5

โดยที่ N(p) และ N(q)คือความหนาแน่นโอกาส (The Population density)ของสถานะที่ p และq ตามลำดับ ซึ่ง p และ q คือสองระดับชั้นพลังงานที่มีพลังงาน E_p และ E_q และที่มีตัวถ่วง น้ำหนักทางสถิติ (statistical weights)เป็น g_p และ g_q ตามลำดับ และสำหรับแต่ละระดับชั้น พลังงาน ความหนาแน่นไอออนสามารถเขียนได้เป็น

$$N_{p} = N \frac{g_{p}}{U_{e}} \exp\left(-\frac{E_{p}}{kT_{e}}\right)$$
3.6

เมื่อ *U* ศือ พาร์ทิชัน ฟังก์ชัน(partition function)ของอิเล็กตรอนซึ่งมีค่าดังสมการ

$$U_e = \sum_{allj} g_p \exp\left(-\frac{E_j}{kT_e}\right)$$
3.7

และ

$$N = \sum_{allj} N(j)$$
 3.8

ในวิทยานิพนธ์นี้ใช้สมการ 3.6 จากแบบจำลองสมดุลอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่มา คำนวณหาอุณหภูมิอิเล็กตรอน เพื่อให้ทราบถึงพลังงานของพลาสมาที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที่ สร้างขึ้น ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในการนำไปใช้คำนวณจะได้กล่าวในบทถัด

3.2 แบบจำลองของวงจรของเครื่องพีไอซีพี

ดังที่ได้ทราบมาแล้วว่า เครื่องพีไอซีพีประกอบด้วยตัวเก็บประจุ ขดลวด รอบเดียว และตัว ต้านทาน เราสามารถหาค่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในวงจรของเครื่อง พีไอซีพีได้โดย อาศัยวงจรเสมือน RLC โดยถือว่าค่า ความเหนี่ยวนำ (L) ภายในวงจรเกิดจาก 2 ส่วน คือค่าความ เหนี่ยวนำของขดลวดแบบรอบเดียว (L_c) และค่าความเหนี่ยวนำของอุปกรณ์ภายในวงจร (L₀) ดัง รูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 รูปวาดแสดงวงจรของเครื่องพีไอซีพี[1]

โดยที่

I_c คือค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจร

C₀ คือค่าความจุประจุรวมของทั้งวงจร (ทั้งจากตัวเก็บประจุความจุสูงและอุปกรณ์ต่างๆ)

R₀ คือความต้านทานรวมของทั้งวงจร

เมื่อ ค่าความต่างศักย์ที่ให้กับตัวเก็บประจุคือ V₀ ซึ่งความต่างศักย์V₀นี้มีค่าเท่ากับความ ต่างศักย์ที่ตกคร่อมอุปกรณ์ต่างๆรวมกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้เป็น[8]

$$V_{0} = R_{0}I_{c} + \frac{\int I_{c}dt}{C_{0}} + \frac{d}{dt} \{L_{0}I_{c} + L_{c}I_{c}\}$$
3.9

จัดรูปสมการ 3.9 ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณได้เป็น
$$\frac{d}{dt} \{ L_0 I_c + L_c I_c \} = V_0 - R_0 I_c - \frac{\int I_c dt}{C_0}$$
 3.10

ในสมการที่ 3.2.3 ค่า I_c, L_c เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า จึงต้องหาค่ามาแทนในสมการเพื่อทำการ คำนวณโดยค่า I_c สามารถหาได้จากการทดลองซึ่งจะศึกษาในบทถัดไป แต่ค่า L_c สามารถหาจาก การคำนวณ โดยพิจารณาสนามแม่เหล็ก ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของ กระแสไฟฟ้าที่ไหลภายใน วงจร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก และระบบจะทำการสร้างสนามแม่เหล็กต้านการ เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก จากกระแสภายนอก ตาม กฎของเลนส์ (Lentz's Law) ดังที่ได้ แสดงไว้ในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 รูปวาดแสดงสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้า I_c ที่ไหลในวงจร[1]

โดยที่ A₁ คือพื้นที่อยู่ระหว่างขดลวดรอบเดียวกับ กระแสพลาสมา, A₂ คือพื้นที่ภายใน กระแสพลาสมา, B₁ คือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้า I_c ที่ไหลในขดลวด แบบรอบเดียว และ B₂ คือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสพลาสมา I_cที่ระบบสร้างขึ้น

จาก∫B·dl=μI สนามแม่เหล็กมีค่าเป็น

$$B_1 = \frac{\mu I_c}{l}$$
 3.11

$$\mathbf{B}_{2} = \frac{\mu}{l} \left(\mathbf{I}_{c} - \mathbf{I}_{p} \right)$$
 3.12

และจาก L=�/I โดยที่ �=BA จึงสามารถเขียนค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดรอบเดียว (L_c) ได้ ดังสมการ 3.13

$$L_{c} = \frac{B_{1}A_{1} - B_{2}A_{2}}{I_{c}}$$
 3.13

$$L_{c} = \frac{\frac{\mu I_{c} \pi}{l} (r_{c}^{2} - r_{p}^{2}) - \frac{\mu \pi r_{p}^{2}}{l} (I_{p} - I_{c})}{I_{c}}$$
3.14

โดยที่ r_c ,r_p คือรัศมีของขดล<mark>วดรอบเดียว</mark>และรัศมีข<mark>องพลาสม</mark>าตามลำดับ จัดรูปสมการ

$$L_{c} = \frac{\mu\pi}{l} \left(r_{c}^{2} - r_{p}^{2} \right) - \frac{\mu\pi r_{p}^{2}}{l} (m-1)$$
 3.15

โดยที่ m = I_p/I_c ค่า m นี้อาจเรียกว่าความเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (mutual inductance)

$$L_{c} = \frac{\mu\pi}{l} \left\{ \left(r_{c}^{2} - r_{p}^{2} \right) - r_{p}^{2} \left(m - 1 \right) \right\}$$
 3.16

$$L_{c} = \frac{\mu\pi}{l} \left(r_{c}^{2} - r_{p}^{2} m \right)$$
 3.17

แทนค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดแบบรอบเดียวลงในสมการ 3.10

$$\frac{d}{dt} \left\{ L_0 I_c + \frac{\mu \pi}{l} \left(r_c^2 - r_p^2 m \right) I_c \right\} = V_0 - R_0 I_c - \frac{\int I_c dt}{C_0}$$
3.18

ทำการหาอนุพันธ์ และจัดรูปสมการ ก็จะได้สมการเป็น

$$\frac{dI_{c}}{dt} = \frac{V_{0} - R_{0}I_{c} - \frac{\int I_{c}dt}{C_{0}} + \frac{2\mu\pi}{1}mr_{p}I_{c}\frac{dr_{p}}{dt}}{L_{0} + \frac{\pi\mu}{1}r_{c}^{2} - \frac{\pi\mu}{1}mr_{p}^{2}}$$
3.19

จากสมการ 3.19 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในวงจรของเครื่องพีไอซีพีที่ขึ้นกับเวลา เพื่อให้การคำนวณสามารถทำได้ง่ายขึ้น จึงทำการกำหนดตัวแปรใหม่เพื่อนำมาใช้ในการปรับ สมการโดยกำหนดให้ i_c= I_c/I_o ,τ= t /t_o ,κ_p= r_p/r_c , κ_s= r_s/r_c แทนค่าของตัวแปรทั้งหมดลงใน สมการ3.19 และจัดรูปของสมการได้เป็น

$$\frac{I_{0}}{t_{0}}\frac{di_{c}}{d\tau} = \frac{V_{0} - R_{0}I_{0}i_{c} - \frac{t_{0}I_{0}\int i_{c}d\tau}{C_{0}} + \frac{2\mu\pi}{1}mr_{c}^{2}i_{c}\kappa_{p}\frac{I_{0}}{t_{0}}\frac{d\kappa_{p}}{d\tau}}{L_{0} + \frac{\pi\mu}{1}r_{c}^{2} - \frac{\pi\mu}{1}mr_{c}^{2}\kappa_{p}^{2}}$$
3.20

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{c}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{1 - \delta\mathbf{i}_{c} - \int \mathbf{i}_{c}\mathrm{d}\tau + 2\beta \mathrm{m}\mathbf{i}_{c}\kappa_{p}\frac{\mathrm{d}\kappa_{p}}{\mathrm{d}\tau}}{1 + \beta - \beta \mathrm{m}\kappa_{p}^{2}} \qquad 3.21$$

โดยที่ I₀ = กระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจร, $t_0 = T/2\pi$, T คือคาบเวลาของกระแสไฟฟ้า $\delta = r_0 / \sqrt{L_0 / C_0}$ และ $\beta = \frac{\pi \mu r_c^2 / l}{L_0}$ และเรียกสมการ3.21 ว่า สมการวงจร (Circuit Equation) โดยการปรับค่า m ในสมการ 3.21 ให้สอดคล้องกับการทดลอง ก็จะได้ค่า m เพื่อไปใช้ใน แบบจำลองการเคลื่อนที่ของพลาสมาต่อไป



3.3 แบบจำลองทางทฤษฎีของการเคลื่อนที่ของกระแสพลาสมา

การเคลื่อนที่ของพลาสมาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าที่ ไหลผ่าน ขดลวดรอบเดียว ให้เคลื่อนที่เข้ามาตามแนวรัศมี นั้น สมการการเคลื่อนที่สามารถที่จะหาได้โดย อาศัยแบบจำลองสลัก[10] (Slug Model)





โดยแบบจำลองสลักแสดงการเคลื่อนที่ของพลาสมาเข้ามาตามแนวรัศมีเป็นลักษณะของ คลื่นกระแทก ประกอบด้วยพิสตัน (piston)หรือพลาสมาชีท(Plasma Sheet) ซึ่งก็คือแผ่นกระแส พลาสมาที่เคลื่อนที่เข้ามาตามแนวรัศมีด้วยความเร็วสูง โดยในขณะเคลื่อนที่ก็จะกวาดอากาศที่อยู่ ข้างหน้าไปด้วย ชั้นของอากาศที่ถูกกวาดเข้ามาด้วยความเร็วสูงนี้ก็มีโอกาศแตกตัวกลายเป็น พลาสมา และ ผิวหน้าคลื่นกระแทก (Shock Front) ในรูปที่3.3 r_s คือ รัศมีช็อค (shock radius) และ r_p คือ รัศมีพิสตัน (piston radiusl) โดยในการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแทกนั้นมวลรวมมีค่าคงที่ แบบจำลองสลัก เริ่มจากความสัมพันธ์แบบอาเดียบาติก (Adiabatic Relationship) โดย ที่กำหนดให้มวลของก๊าซภายในมีมวลคงที่ ในที่มีการเปลี่ยนแปลงของรัศมี dr_s ซึ่งจะได้ว่า [8]

 $PV^{\gamma} = constant$

หรือ

$$\frac{\gamma dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \qquad 3.23$$

และจากความดันสลัก $\mathbf{P} \sim \mathbf{v}_{\mathrm{s}}^{2}$ เมื่อแทนค่าได้เป็น

$$\frac{\mathrm{dP}}{\mathrm{P}} = \frac{2\mathrm{dv}_{\mathrm{s}}}{\mathrm{v}_{\mathrm{s}}}$$
 3.24

และจากความสัมพันธ์ $\mathbf{v}_{s} \sim \frac{\mathbf{I}_{c}}{\mathbf{r}_{p}}$ ดั้งนั้นสมการ 3.24 ได้ค่าเป็น[9] $\frac{\mathrm{dP}}{\mathrm{P}} = 2 \left(\frac{\mathrm{dI}_{c}}{\mathrm{I}_{c}} - \frac{\mathrm{dr}_{p}}{\mathbf{r}_{p}} \right)$ 3.25

จากรูปที่ 3.3 หากเราพิจารณาปริมาตรของพลาสมาที่เคลื่อนที่

 $V = \pi (r_p^2 - r_s^2) z$ หรือ $dV = 2\pi (r_p dr_p - r_s dr_s) z$

แต่ก๊าซที่ถูกกวาดไปกับการเคลื่อนที่ของหน้าคลื่นกระแทกเป็นระยะ dr_s จะถูกบีบด้วย อัตราส่วน (γ+1)/(γ-1) และอยู่ในส่วนของปริมาตรที่ เปลี่ยนแปลงนี้ ด้วย ดั้งนั้นค่าที่ใช้ในการ เปลี่ยนแปลง ปริมาตรนั้นไม่ใช่เป็นผลมาจากการ เปลี่ยนแปลงของแค่ dr_s แต่ต้องเป็นผลมาจาก dr_s (2/(γ+1)) ผลที่ถูกต้องจึงเป็น[10]

$$d\mathbf{V} = 2\pi \left(\mathbf{r}_{\mathrm{p}} d\mathbf{r}_{\mathrm{p}} - \frac{2}{\gamma + 1} \mathbf{r}_{\mathrm{s}} d\mathbf{r}_{\mathrm{s}} \right) \mathbf{z}$$
 3.26

เมื่อ γ คืออัตราส่วนความร้อนจำเพาะ (specific heat ratio)

$$\frac{\gamma dV}{V} = \frac{2\gamma \left(r_{p} dr_{p} - \frac{2}{\gamma + 1} r_{s} dr_{s}\right)}{\left(r_{p}^{2} - r_{s}^{2}\right)}$$
3.27

เมื่อแทนค่าทั้งหมดในสมการ 3.23 จะได้เป็นสมการใหม่คือ

$$\frac{2\gamma \left(r_{p} dr_{p} - \frac{2}{\gamma + 1} r_{s} dr_{s}\right)}{\left(r_{p}^{2} - r_{s}^{s}\right)} + 2\frac{dI_{c}}{I_{c}} - \frac{2dr_{p}}{r_{p}} = 0$$
3.28

จากนั้นจัดรูปสมการใหม่เพื่อหาการเคลื่อนที่ของพลาสมาได้เป็น

$$\frac{dr_{p}}{dt} = \frac{\frac{2\gamma}{\gamma+1} \frac{r_{s}r_{p}}{(r_{p}^{2} - r_{s}^{2})} \frac{dr_{s}}{dt} - \frac{r_{p}}{I_{c}} \frac{dI_{c}}{dt}}{\frac{\gamma r_{p}^{2}}{(r_{p}^{2} - r_{s}^{2})} - 1}$$
3.29

dr_p/dt คือ อัตราเร็วของพิสตัน (piston's speed) หรือคือความเร็วของพลาสมา และจากค่าตัวแปรที่ได้กำหนดไว้ในตอนต้น เมื่อแทนในสมการ 3.29 ได้สมการใหม่เป็น[11]

$$\frac{\mathrm{d}\kappa_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\frac{2}{\gamma+1}\frac{\kappa_{\mathrm{s}}}{\kappa_{\mathrm{p}}}\frac{\mathrm{d}\kappa_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}\tau} - \frac{\kappa_{\mathrm{p}}}{\gamma i_{\mathrm{c}}}\left(1 - \frac{\kappa_{\mathrm{s}}^{2}}{\kappa_{\mathrm{p}}^{2}}\right)\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d}\tau}}{\frac{\gamma-1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma}\frac{\kappa_{\mathrm{s}}^{2}}{\kappa_{\mathrm{p}}^{2}}}$$

$$3.30$$

ในส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไป เป็นการกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของพลาสมาภายใต้ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสที่ไหลในขดลวด โดยเราจะพิจารณาจากความดันของ สนามแม่เหล็ก (Magnetic Pressure: P_m) ซึ่งมีค่าตามสมการ

โดยที่ความดันของสนามแม่เหล็กที่เป็นตัวขับเคลื่อนพลาสมามีค่าเท่ากับผลต่างของความดันของ สนามแม่เหล็กในสองบริเวณตามสมการ

$$P_{m12} = P_{m1} - P_{m2}$$
 3.32

เมื่อแทนค่าความดันของสนามแม่เหล็กในแต่ละบริเวณลงไปในสมการได้[8]

$$P_{m12} = \frac{m\mu I_c^2}{2l^2} (2-m)$$
 3.33

ความดันขับเคลื่อนของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากผลต่างของความดันสนามแม่เหล็กในสองบริเวณนี้ เท่ากับความดันของคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$\frac{m\mu I_{c}^{2}}{2l^{2}}(2-m) = \frac{2}{\gamma+1}f_{m}\rho_{0}v_{s}^{2}$$
3.34

โดยที่ f_m= อัตราส่วนมวล , ρ₀=ความหนาแน่นของก๊าซ และ v₅² คือความเร็วของผิวหน้าคลื่น กระแทก[10] จัดรูปสมการเพื่อหาความเร็วของคลื่นกระแทก ได้เป็น

$$v_{s} = \frac{dr_{s}}{dt} = \left[\frac{m\mu I_{c}^{2}}{2l^{2}}(2-m)\left(\frac{\gamma+1}{2f_{m}\rho_{0}}\right)\right]^{\frac{1}{2}}$$
3.35

dr_s / dt คือ อัตราเร็วของผิวหน้าคลื่นกระแทก (shock's speed) และจาก $i_c=I_c/I_0, \tau=t/t_0, \kappa_s=r_s/r_c$ แทนค่าตัวแปรลงในสมการด้านบน และทำการจัดสมการใหม่ ได้

$$\frac{\mathrm{d}\kappa_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}\tau} = \left[\frac{\mathrm{m}\mu(2-\mathrm{m})(\gamma+1)}{4\mathrm{f}_{\mathrm{m}}\rho_{0}}\right]^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{I}_{0}}{1} \frac{\mathrm{t}_{0}}{\mathrm{r}_{\mathrm{c}}} \mathrm{i}_{\mathrm{c}}$$
3.36

เมื่อกำหนดให้
$$t_p = \frac{r_c l}{I_0} \left[\frac{4f_m \rho_0}{m\mu (2-m)(\gamma+1)} \right]^{\frac{1}{2}}$$
ดังนี้นั้นสมการ 3.36 จึงสามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{\mathrm{d}\kappa_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{t}_{0}}{\mathrm{t}_{\mathrm{p}}}\mathrm{i}_{\mathrm{c}}$$
3.37

หรือ

$$\frac{\mathrm{d}\kappa_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}\tau} = -\alpha_{\mathrm{s}}i_{\mathrm{c}} \qquad 3.38$$

โดยที่ - $\alpha_{\rm s}$ =t₀/t_p

สาเหตุ ที่กำหนดให้ความเร็วของคลื่นกระแทกมีค่าเป็นลบเนื่องมาจากคลื่นกระแทก เคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลาง ทำให้ค่ารัศมีของคลื่นกระแทกมีค่าลดลง จากที่ได้ทำมานี้สมการ 3.38 คือสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นนี้อยู่ ภายในของพลาสมาที่กำลังบีบตัวเข้ามาตามแนวรัศมี [11] เมื่อแทนค่าตัวแปรต่างๆรวมถึงค่า m ที่ ได้จากสมการวงจร แล้วทำการปรับค่า f_m ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของพลาสมาที่วัดจากการ ทดลองก็จะได้ค่า f_m และตำแหน่งของพลาสมาที่เวลาต่างๆ

และจากอัตราเร็วของผิวหน้าคลื่นกระแทกสามารถหาอุณหภูมิอิเล็กตรอนตรมสมการ[8]

$$Te = \frac{M}{R} \frac{\gamma - 1}{(\gamma + 1)^2} \frac{v_s^2}{(1 + Z_{eff})}$$
 3.39

เมื่อ M และ R คือมวลอะตอมและก่ากงที่ของก๊าซตามลำดับ

บทที่ 4 การออกแบบ การสร้างเครื่องพีไอซีพี และเครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดลอง

ในบทนี้อธิบายถึงการออกแบบ และการสร้างเครื่องพีไอซีพี อุปกรณ์หลักของเครื่องพีไอซี พีประกอบด้วย ตัวซาร์จประจุความจุสูง ภาซนะสุญญากาศ ตัวเก็บประจุความจุสูง สปาร์คแก๊บ สวิทซ์ ขดลวดรอบเดียว และบั้มสุญญากาศ แต่ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการออกแบบและการสร้าง ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องเท่านั้น เพื่อให้ทราบถึงที่มาในการออกแบบ และรายละเอียดสำคัญ ที่พึงคำนึงถึงในส่วนประกอบนั้นๆ ของเครื่งพีไอซีพี รายละเอียดแบบงานของส่วนประกอบอื่นๆ สามารถศึกษาได้จากภาคผนวก ก ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องที่จะอธิบายในบทนี้คือ ภาซนะ สุญญากาศ สปาร์คแก๊บสวิทซ์ ขดลวดรอบเดียว และชุดชาร์จประจุความต่างศักย์สูง ลำดับถัดไป ก็จะเป็นการศึกษาเครื่องมือวัดที่จะใช้ในการทดลองซึ่งประกอบด้วย ขดลวดโลโกวสกี้ หัววัด สนามแม่เหล็ก และเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ตามลำดับ

4.1 การออกแบบและการสร้างเครื่องพีไอซีพี

เครื่องพีไอซีพีในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ อุปกรณ์สำคัญและวัสดุพื้นฐาน ที่หน่วยวิจัย เทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่นได้มีอยู่แล้ว บางส่วนประกอบด้วย

1 ท่อควอทซ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 117.2 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน 109.2 มิลลิเมตร และยาว 42 เซนติเมตร

2 ตัวเก็บประจุความจุสูงของ Maxwell Technology รุ่น 33464 ขนาด 30 ไมโครฟารัด ที่ สามาถทนความต่างศักย์ไฟฟ้าได้สูงสุด 20 กิโลโวลต์ จำนวน 2 ตัว

3 ปั้มสุญญากาศแบบโรตารี่ของ EDWARDS รุ่น A363-15-903

4 แผ่นทองแดงขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร จำนวน 1แผ่น และแท่งทองแดงกว้าง 10 เซนติเมตร หนา 10 มิลลิเมตร ยาว 180 เซนติเมตร จำนวน1 แท่ง

ขั้นตอนการ สร้างเครื่องพีไอซีพีได้เริ่มออกแบบจากอุปกรณ์ และวัสดุพื้นฐานที่มี เพื่อเป็นการประหยัดลดต้นทุน



รูปที่ 4.1.1 แผนภาพของเครื่องพีไอซีพีตามแบบเสนออนุมัติโครงร่างวิทยานพนธ์

เนื่องจากตัวเก็บประจุความจุสูงมีขนาด กว้าง
 21.5 ยาว3.5 และสูง 61.2 เซนติเมตร หาก วางภาชนะสุญญากาศไว้ที่ระดับเดียวกับตัวเก็บประจุดังเช่นเครื่องที่ต้าพินซ์ซึ่งตัวเก็บประจุมี
 ความสูง 120 เซนติเมตร จะไม่สะดวกในการเปิดปิดภาชนะสุญญากาศจึงได้ออกแบบในการจัด วางภาชนะสุญญากาศเหนือตัวเก็บประจุเพื่อให้มีความสูงจากพื้นขณะวางบนรถเข็น
 120 เซนติเมตรซึ่งเป็นความสูงที่สะดวกต่อการใช้งาน บนรถเข็นที่มีความกว้าง
 70 ซึ่งกว้างพอสำหรับ วางตัวเก็บประจุสูงจำนวนสองตัว ดังภาพที่ 4.1.2

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่4.1.2 แบบร่างแสดงการจัดวางภาชนะสุญญากาศเหนือตัวเก็บประจุ

จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย

4.1.1 การออกแบบและสร้างภาชนะสุญญากาศ

ในเครื่องพีไอซีพีพลาสมาจะเกิดขึ้นภายในภาชนะสุญญากาศซึ่งทำจากท่อควอทซ์ เนื่องจากเป็นวัสดุใสสามารถสังเกตุพลาสมาได้จากภายนอกและทนความร้อนได้สูง การออกแบบ ภาชนะสุญญากาศจากท่อควอทซ์ปลายเปิด 2 ด้านมีรายละเอียด ที่ควรคำนึงถึงดังนี้



รูปที่ 4.1.3 แผนภาพแสดงภาชนะสุญญากาศ

ภาชนะสุญญากาศที่สร้างขึ้นวางอยู่บนแบคคาไลต์ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเป็นฉนวนสูง การ ปิดทั้งสองด้านใช้วิธีการขันน๊อตบีบอัดโอริง สิ่งทีพึงคำนึงถึงคือต้องเว้นระยะห่างระหว่างฝาปิดที่ เป็นโลหะกับท่อควอทซ์เนื่องจากขณะเกิดพลาสมานั้นท่อควอทซ์จะเกิดการสั่นเล็กน้อย ซึ่งถ้าหาก เว้นระยะมากเกินไปภาชะสุญญากาศก็จะเกิดการรั่วหรือไม่สามารถปั้มลงต่ำได้ และหากน้อย เกินไปก็อาจทำให้ควอทซ์แตกได้ ในที่นี้เว้นระยะไว้ 1.4 มิลิเมตร แบบงานอย่างระเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวกก โคร่งสร้างอย่างง่าย และฝาปิดที่สร้างเสร็จแสดงดังรูปที่ 4.1.4



รูปที่ 4.1.4 ภาพแสดงฝาปิดท่อควอทซ์ในการสร้างภาชนะสุญญากาศ

4.1.2 การออกแบบและสร้างสปาคแก๊บสวิทซ์

ในการปล่อยประจุออกจากตัวเก็บประจุความจุสูงในครั้งเดียวนั้น อาศัยอุปกรณ์ที่ เรียกว่าสปาร์คแก๊บสวิทซ์ซึ่งจะใช้งานร่วมกับอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์ ลักษณะของสปาร์คแก๊บ สวิทซ์ที่ออกแบบนั้นเป็นลักษณะเดียวกับของเครื่องที่ต้าพินซ์แต่มีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของส ปาร์คแก๊บจากเครื่องที่ต้าพินซ์ เนื่องจากใช้งานที่ความต่างศักย์ต่ำกว่า ระยะห่างระหว่างขั้วจึงน้อย กว่า สัดส่วนอื่นๆจึงเล็กลงตามมา โดยใช้วัสดุ ในลอน -6 มาเป็นฉนวนซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มขั้วทั้งสอง ด้านที่เชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุความจุสูงและขดลวดรอบเดียว ขั้วของสปาร์คแก๊บเป็นรูป ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมเกรียวเท่ากับ 50 มิลลิเมตร โดยเป็นขนาดที่ใหญ่เพื่อให้ ความต้านทานต่ำ และขนาดของขั้วเมื่อรวมกับฉนวนห่อหุ้มแล้วมีขนาด 156 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น ขนาดที่พอดีเมื่อนำไปติดตั้งแล้วจะเหลือระยะระหว่างตัวเก็บประจุและแผ่นแบคคาไลต์ที่วาง ภาชนะสุญญากาศ 5 เซนติเมตรเพียงพอสำหรับการทำงาน ตามรูปที่ 4.1.2 ขั้วทั้งสองของสปาร์ คแก๊บเลือกวัสดุที่นำมาใช้เป็นทองเหลืองที่ถึงแม้จะมีสภาพต้านทานสูงกว่าทองแดงแต่เป็นโลหะที่ แข็งกว่าเนื่องจากต้องกลึงเกรียวและมีการขยับปรับระยะห่างระหว่างขั้ว เกรียวของขั้วจึงมีโอกาศ สึกหรอได้น้อยกว่าในระยะยาว สปาคแก๊บที่ออกแบบมีลักษณะดังรูปที่ 4.1.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.1.5 แบบร่างสปาร์คแก๊บสวิทช์



รูปที่ 4.1.6 ภาพแส<mark>ดงสปาร์คแก๊บเมื่</mark>อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ

การที่จะให้ตัวเก็บประจุความจุสูงปลดปล่อยประจุ ออกมา ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างขั้ว กับแผ่นทองแดงตรงกลาง และความต่างศักย์ ที่ตัวเก็บประจุความจุสูง โดยการปรับระยะห่างทั้ง สองด้านให้พอดี คือเมื่อทำการกดสวิทช์ให้สัญญาณจากอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์ก็จะเพิ่มความต่าง ศักย์ระหว่างแผ่นโลหะและขั้วด้านตัวเก็บประจุ ประจุจากตัวเก็บประความจุสูงก็สามารถกระโดด ผ่านไปสู่ขั้วด้านขดลวดรอบเดียวเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ หากระยะห่างนี้น้อยไปประจุก็ จะกระโดดก่อนที่จะทำการชาร์จประจุแล้วเสร็จและก่อนกดให้สัญญาณจากอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์ แต่หากระยะห่างนี้มากไปประจุก็จะไม่สามารถกระโดดไปสู่ขั้วด้านขดรอบเดียวได้แม้จะกดให้ สัญญาณจากอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์แล้วก็ตาม (อาจดูรูปที่ 2.9 ประกอบ) เพราะฉะนั้นการที่จะให้ เครื่องพีไอซีพีทำงานขณะมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุค่าใดหรือความต่างศักย์ค่าใด้นั้นขึ้นอยู่ กับการปรับระยะห่างระหว่างแผ่นทองแดงตรงกลางกับขั้วทั้งสองด้านของสปาร์คแก๊บสวิทช์

ในงานวิจัยทำการทดลองเครื่องพีไอซีพีที่มีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุคือ 1.4, 2.4, และ 4.32 กิโลจูลซึ่งเกิดจากการชาร์จประจุจนมีความต่างศักย์เป็น 6.83, 8.94 และ12 กิโลโวลต์ ตามลำดับ เพราะฉะนั้นจึงต้องทำการปรับระยะห่างระหว่างขั้วทั้งสองด้านกับแผ่นทองแดงตรง กลางให้เหมาะสมกับทั้งสามความต่างศักย์ งานวิจัยนี้ได้ให้เครื่องพีไอซีพีทำงานที่ระดับพลังงาน ต่างๆเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบสมบัติของพลาสมาที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที่มีพลังงานสะสม ในตัวเก็บประจุที่น้อยกว่า เท่ากัน และที่พลังงานมากกว่าเครื่องทีต้าพินซ์ ตามลำดับ โดยพลังงาน สูงสุดของเครื่องพีไอซีพีที่ 4.32 กิโลจูลเกิดจากการสะสมประจุที่ตัวเก็บประจุความจุสูงจนถึงความ ต่างศักย์ 12 กิโลโวลต์เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวเก็บประจุความจุสูงซึ่งสามารถรับ ความต่างศักย์ได้สูงสุด 20 กิโลโวลต์ ทั้งนี้เพราะการชาร์จประจุเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหากทำการตั้ง ค่าความต่างศักย์สูงสุดใกล้กับ 20 กิโลโวลต์ โอกาศที่จะทำการชาร์จประจุลนมีความต่างศักย์เกิน 20 กิโลโวลต์และสร้างความเสียหายต่อตัวเก็บประจุความจุสูงอาจเกิดขึ้นได้

4.1.3 การออกแบบและสร้างขดลวดรอบเดียว

เนื่องจากสนามการออกแบบขดลวดรอบเดียวได้คำนึงถึงการลดค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (Self Inductance: L) เป็นสำคัญ ซึ่งค่าความเหนี่ยวนำตัวเองเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งจะต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสภายในขดลวด พิจารณาจากค่า ความเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวดโซลินอยด์เป็นไปตามสมการ

$$L = \mu n^2 l A \tag{4.1.1}$$

โดยที่ μ คือสภาพซึมได้ของตัวกลางี่ขดลวดพันรอบ n คือจำนวนรอบของขดลวดต่อหน่วยความ ยาว *l* คือความยาวขดลวด และ A คือพื้นที่หน้าตัดขดลวด

เพื่อให้ค่าความเหนี่ยวนำตัวเองมีค่าต่ำสุด การสร้างขดลวดจึงควรมีจำนวนรอบของ ขดลวดน้อยสุด นั่นคือรอบเดียว (ขณะที่พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดต้องมากเพื่อให้ความต้านทานมี ค่าน้อย) และมีพื้นที่หน้าตัดน้อยสุดนั่นคือมีรัศมีน้อยสุด ในที่นี้ได้ออกแบบขดลวดรอบเดียวได้ใช้ ้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเพราะต้องใช้ในปริมาณมากซึ่งเป็นโลหะที่ราคาไม่สูงขณะที่มีสภาพนำไฟฟ้าอยู่ ในระดับที่ดี เนื่องจากท่อควอทซ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับ 117.2 มิลลิเมตร จึง ้ออกแบบขดลวดรอบเดียวให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 128 มิลลิเมตร เพื่อให้มีช่องว่างระหว่าง ้ควอทซ์กับขดลวดเหลือเป็นระยะ 5.4 มิลลิเมตร เมื่อรองแผ่นไมลาร์ด้านละ 10 แผ่นก็จะมีช่องว่าง ระหว่างขดลวดกับท่อควอทซ์ 3.4 มิลลิเมตรเพียงพอสำหรับการสั่นของท่อควอทซ์โดยไม่กระทบ กับขดลวดรอบเดียวขณะเกิดพลาสมาภายใน ในงานวิจัยนี้สร้างขดลวดรอบเดียวจากอลูมิเนียม แผ่นซึ่งมีความหนา 64 มิลลิเมตร วางเรียงกัน 4 ชุดโดยแต่ละชุดห่างกัน 5 มิลลิเมตร โดยถือว่า ขดลวดรอบเดียวที่แยกเป็น 4 ชุดนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยกับสนามแม่เหล็ก ที่เกิดจากขดลวดลวดรอบเดียวที่เป็นชิ้นเดียวกัน แต่เนื่องจากความหนาของแผ่นอลูมิเนียมที่มีขาย ตามท้องตลาดมีความหนามากสุดที่ 64 มิลลิเมตร จึงได้ออกแบบเป็น 4 ชุดเพื่อให้มีพื้นที่หน้าตัด ของเส้นลวดรวมมากสุดให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี และเมื่อทำการติดตั้งขอบของขดลวดอันที่ 1 และ 4 จะมีระยะห่างจากฝาปิดท่อควอทซ์ที่ทำจากสเตนเลส 8 เซนติเมตร เป็นระยะที่เพียงพอที่ กระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ 20 กิโลโวลต์ (หากให้เครื่องทำงานที่พลังงานสูงสุดของตัวเก็บประจุ) จะกระโดดไปไม่ถึง การออกแบบขดลวดรอบเดียวได้ออกแบบเป็นสองส่วนเพื่อความสะดวกในการ ติดตั้งโดยไม่กระทบกับท่อควอทซ์ แบบงานของขดลวดรอบเดียวมีลักษณะดังรูป 4.1.7 และแสดง การติดตั้งเมื่อทำการสร้างเสร็จดังรูปที่ 4.1.8





รูปที่ 4.1.8 ภาพแสดงข<mark>ดลวดรอบเดีย</mark>วที่สร้างและทำการติดตั้งแล้วเสร็จ

โดยขดลวดรอบเดีย<mark>วจะถูกต่อเข้</mark>ากับสปาร์<mark>คแก็บสวิทช์</mark>และด้วยข้อต่อที่ทำจากแผ่น ทองแดง ดังรูปที่ 4.1.9



รูปที่4.1.9 ภาพข้อต่อสำหรับใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า

4.1.4 การสร้างเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง

การสร้างเครื่องซาร์จประจุความต่างศักย์สูงในการวิจัยครั้งนี้ได้แยกระบบชาร์จออกเป็น สองส่วนคือส่วนที่มีความต่างศักย์ต่ำคือส่วนควบคุม และส่วนที่มีความต่างศักย์สูงซึ่งจะแปลง กระแสไฟฟ้าจากศักย์ต่ำเป็นศักย์สูง โดยจะวางไว้ใกล้กับตัวเก็บประจุความจุสูงเพื่อป้องกัน อันตรายและได้ติดตั้งส่วนควบคุมของอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์ไว้กับส่วนควบคุมของเครื่องซาร์จ ประจุด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน วงจรของเครื่องซาร์จประจุความจุสูงมีลักษณะดังรูปที่ 4.1.10 และวงจรของอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์แสดงดังรูป4.1.11



รูปที่ 4.1.10 วงจรเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง



รูปที่ 4.1.11 วงจรอิเล็กทรอนิกทริกเกอร์



รูปที่ 4.1.12 ภาพเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง แสดงส่วนควบคุม (รูปซ้าย) และส่วนไฟฟ้าความต่างศักย์สูง(รูปขวา)

ในงานวิจัยครั้งนี้ได้วางแผนหาสมบัติของเครื่องและสมบัติของพลาสมาจากเครื่องพีไอซีพี ที่พลังงาน 1.4, 2.4 และ 4.32 กิโลจูล จากตัวเก็บประจุความจุสูงขนาด 60 ไมโครฟารัด (30 ไมโคร ฟารัดสองตัวต่อขนานกัน) เพราะฉะนั้นจึงต้องทำการชาร์จประจุ ไปจนมีความต่างศักย์ขนาด 6.83, 8.94 และ 12 กิโลโวลต์ตามลำดับ แต่เราสามารถชาร์จประจุไปถึงความต่างศักย์ดังกล่าว โดยดูจากแอมมิเตอร์ที่ส่วนควบคุมของเครื่องชาร์จประจุ ซึ่งอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ลดทอนจาก วงจรผ่านตัวต้านทานขนาด 600 เมกะโอมห์ โดยดูจากควาสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จาก แอมมิเตอร์และความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุความจุสูงในขณะทำการชาร์จประจุ แสดงดังรูปที่



รูปที่ 4.1.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าที่ลดทอนจากตัวเก็บประจุ และความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุขณะทำการชาร์จ



รูปที่ 4.1.<mark>14</mark> ภา<mark>พเครื่องพีไอซีพีที่ทำการสร้างแล้วเสร็จ</mark>



4.1.5 การใช้งานเครื่องพีไอซีพี



รูปที่4.1.15 ภาพ<mark>แสด</mark>งรายละเอียดของเครื่องชาร์จประจุความต่างศักย์สูง

การใช้งานเครื่องพีไอซีพี เริ่มจาก

- ทำการทำการชาร์จประจุให้กับตัวเก็บประจุความจุสูง เริ่มต้นจากเปิดสวิทช์หลักของ เครื่องชาร์จประจุ (Main Switch) จากนั้นหมุนวาริแอคเพื่อตั้งศักย์ไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับ วงจรส่วนไฟสูง ในงานวิจัยนี้ตั้งไว้ที่ 200 โวลต์โดยดูจากโวลต์มิเตอร์ เพื่อป้องกันการ เสียหายที่จะเกิดกับสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่างๆในระยะยาว
- เปิดแมกเนติกสวิทซ์ เพื่อตัดวงจรระหว่างตัวเก็บประจุกับกราวน์ และสับเบรคเกอร์เพื่อ เชื่อมต่อวงจรระหว่างวงจรส่วนความต่างศักย์สูงและความต่างศักย์ต่ำ
- เมื่อต้องการชาร์จประจุทำการเปิดสวิทช์ (On Switch) กระแสไฟฟ้าจะไหลจากวาริแอก ผ่านวงหม้อแปลงขาขึ้นความต่างศักย์สูง (Neon Transformer) ผ่านวงจรแปลงกระแส เป็นกระแสตรง(Bridge) ผ่านตัวต้านทาน แล้วเข้าสู่ตัวเก็บประจุความจุสูง ความต่างศักย์ ที่ตัวเก็บประจุความจุสูงจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยดูจากแอมมิเตอร์
- เมื่อถึงความต่างศักย์ที่ต้องการแล้วทำการปิดสวิทช์ (Off Switch)กระแสไฟฟ้าก็จะหยุด ใหลเข้าสู่ตัวเก็บประจุควมจุสูง

- เมื่อความดันภายในภาชนะสุญญากาศมาถึงระดับที่ต้องการ ทำการปิดวาล์วปั้ม ปิด วาล์วและสวิทช์เกจน์เพื่อป้องกันความเสียหายจากสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าที่อาจ กระโดดเข้ามา
- ทำการปล่อยประจุจากตัวเก็บประจุความจุสูงโดยการเปิดและกดสวิทช์ทริกเกอร์ ประจุ ไฟฟ้าก็จะไหลออกจากตัวเก็บประจุเข้าสู่ขดลวดรอบเดียว
- เมื่อทำการปล่อยประจุแล้วทำการยกเบลคเกอร์เพื่อตัดวงจร และปิดแมกเนติกสวิทช์
 เพื่อให้ประจุที่ค้างอยู่ที่ตัวเก็บประจุความจุสูงไหลผ่านตัวต้านทานลงกราวน์
- หากมีกรณีฉุกเฉิน ต้องทำการปลดปล่อยประจุลงกราวน์โดยการปิดแมกเนติกสวิทช์ หรือ กดสวิทช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch) ก็จะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่เข้าสู่วจรควบคุม แมกเนกติกสวิทช์ก็จะปิด ประจุไฟฟ้าจากตัวเก็บประจุก็จะไหลผ่านตัวต้านทานลงกราวน์ ในที่สุด

จากนั้นทำการทดสอบเครื่องพีไอซีพีโดยการหาความดันสูงสุดที่สามารถกำเนิดพลาสมา จากก๊าซไนโตรเจน โดยดูจากความดันสูงสุดที่ไม่เกิดพลาสมาสังเกตุจากการที่ไม่ปรากฏ สัญญาณจากเครื่องสเปคโตรมิเตอร์(จะอธิบายในหัวข้อถัดไป) ผลที่ได้แสดงดังรูป



ที่พลังงานต่างๆของเครื่องพีไอซีพี

จากรูปแสดงให้เห็นว่าเครื่องพีไอซีพีที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้โดยมีพลังงานสะสมในตัว เก็บประจุขนาด 1.4 กิโลจูล หัวข้อต่อไปจะมาศึกษาสมบัติเครื่องและสมบัติของพลาสามาพีไอซีพี ที่สร้างขึ้น

4.2 เครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดลอง

หลังจากเครื่องพีไอซีพีถูกสร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการศึกษาสมบัติของ เครื่องซึ่งก็คือค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรด้วยขดลวดโรโกวสกี้ และ ทำการวัด ตำแหน่งของ พลาสมาที่เวลาต่างๆ ด้วยหัววัดสนามแม่เหล็ก เพื่อหาความเร็วของพลาสมา วัดอุณหภูมิ อิเล็กตรอนด้วยเครืองสเปคโตรมิเตอร์ สรุปเครื่องมือวัดที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ขดลวดโรโกวสกี้ หัววัดสนามแม่เหล็ก และเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ โดยเครื่องมือสองชนิดแรก จะต้องทำการจัดสร้างขึ้น รายละเอียดของเครื่องมือต่างๆและทฤษฎีในการหาค่าสมบัติที่ต้องการ จะอธิบายดังต่อไปนี้

4.2.1 ขดลวดโรโกวสกี้ (Rogowski coil)



รูปที่4.2.1 รูปวาดขดลวดโรโกวสกี้ เมื่อ r คือความต้านทานภายในของเส้นลวด และ R คือความตานทานภายนอก[7]

กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรของเครื่องพีไอซีพีผ่านขดลวดรอบเดียว เป็นกระแสไฟฟ้าที่มา จากการสะสมประจุในตัวเก็บประจุแล้วปล่อยออกมาในช่วงเวลาสั้นๆ กระแสไฟฟ้าที่ได้จึงมีค่าสูง มาก หากทำการวัดกระแสไฟฟ้าจากวงจรโดยตรงอาจสร้างความเสียหายต่อเครื่องมือวัดได้ การ วัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขดลวดโรโกวสกี้อาศัยสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของ กระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจร สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลในขดลวดโร โกวสกี้ จากรูปที่ 4.2.1 เมื่อทำการวัดสัญญาณคร่อมความต้านทานภายนอกแล้วนำสัญญาณที่วัด ได้ มาทำการคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจร โดยขดลวดโรโกวสกี้ ถูกนำไปวางไว้ที่รอบขั้วไฟฟ้า ซึ่งต่ออยู่กับขดลวดแบบรอบเดียวดังรูปที่ 4.2.2



รูปที่ 4.2.2 รูปวาดแสดงการต่อขดลวดโรโกวสกี้รอบขั้วไฟฟ้า



รูปที่ 4.2.3 ภาพขดลวดโรโกวสกี้ที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 4.2.4 ภาพการต่อขดลวดโรโกวสกี้รอบขั้วไฟฟ้าในการทดลองจริง



สัญญาณจากขดลวดโรโกวสกี้ จะถูกส่งมาตามสายสัญญาณแบบแกนร่วม (coaxial) และ ถูกบันทึกไว้ด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป Tektronik รุ่น TDS 3054 ซึ่งจะถูกวางไว้ในตู้โลหะ ตลอดเวลา เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน แสดงตามรูป 4.2.6 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของ สนามแม่เหล็กที่ขดลวดโรโกวสกี้สามารถวัดได้ดังรูปที่ 4.2.7



รูปที่ 4.2.6 ภาพการต่อสายสัญญาณจากภายนอกเข้าสู่ออสซิลโลสโคป

การคำนวณหาค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจร ทำได้โดยการนำค่าจากสัญญาณที่ วัดได้มาเทียบกับค่า K ซึ่งเป็นตัวแปรที่คำนวณได้จากวงจรเสมือนของวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า ดัง รูปที่ 4.2.7สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ขดลวดโรโกวสกี้สามารถวัดได้ดังรูปที่ 4.2.8^[12]



การคำนวณหาค่าตัวแปร K เริ่มจากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร (I₀) เป็นไปตามสมการ 4.1[12]

$$I_{o} = \frac{\pi C_{o} V_{o} (1+f)}{T}$$

$$4.1$$

โดยที่

$$f = \frac{1}{3} \left(\frac{V_2}{V_1} + \frac{V_3}{V_2} + \frac{V_4}{V_3} \right)$$
 4.2

C₀ = ค่าความจุของตัวเก็บประจุ

V₀ = ค่าความต่างศักย์ที่ให้กับ<mark>ตัวเก</mark>็บประจุในตอนเริ่มต้น

T = คาบเวลาที่วัดได้จากสัญญาณ

วงจรเสมือนที่ในงานวิจัยครั้งนี้มีค่า C₀ 12 ไมโครฟารัด V₀=20กิโลโวลต์ ค่าของกระไฟฟ้า ที่ไหลในวงจรเสมือนที่ได้จากการคำนวณ และค่าของความต่างศักย์ที่วัดได้จากออสซิลโลสโคป สามารถนำมาหาเป็นค่า K เป็นไปตามสมการ

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{I}_{o}}{\mathbf{V}_{1}}$$
 4.3

ตัวแปร K ที่ได้เป็นแปรเพื่อใช้ในการเปลี่ยนเทียบจากสัญญาณที่วัดได้จากออสซิลโลสโคป เป็นกระแสไฟฟ้าของวงจรนั้นๆได้ โดยการวัดค่าความต่างศักย์จากออสซิลโลสโคปแล้วนำมาคูณ กับตัวแปร K ก็จะสามารถทราบค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ไหลในวงจรสำหรับการทดลองครั้งนั้นๆได้

4.2.2 หัววัดสนามแม่เหล็ก (Magnetic probe)

ดังที่ทราบมาแล้วว่าพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพีนั้นจะมีการเคลื่อนที่เข้ามาตามแนว รัศมี พลาสมาประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุ เมื่อแผ่นพลาสมาเคลื่อนผ่านบริเวณใดสนามแม่เหล็ก บริเวณนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหากมีขดลวดเล็กๆวางอยู่บริเวณที่พลาสมาชีทเคลื่อนที่ผ่านก็ จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำในเส้นลวดของขดลวดนั้น หากมีขดลวดเล็กนี้มากกว่า 1 อันวางที่ตำแหน่ง ต่างกัน กันกระแสเหนี่ยวนำในขดลวดแต่ละอันก็จะเกิดที่เวลาต่างกัน ความต่างของเวลาจาก สัญญาณที่เกิดจากกระแสเหนี่ยวนำนี้ และระยะห่างระหว่างขดลวดเล็ก ก็จะทำให้เราทราบถึง ตำแหน่งที่เวลาต่างกันในการเคลื่อนที่ของพลาสมา รวมถึงความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาในช่วง ระยะห่างนั้น ขดลาดเล็กนี้เรียกว่า หัววัดสนามแม่เหล็ก



รูปที่4.2.9 แผนภาพแสดงการจัดวางหัววัดสนามแม่เหล็ก

งานวิจัยนี้ใช้หัววัดสนามแม่เหล็กในการหาตำแหน่งที่พลาสมาเคลื่อนที่ และควมเร็วเฉลี่ย ในการเคลื่อนที่ของพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพี โดยทำการสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กที่มี จำนวนรอบของขดลวด 30 รอบ จำนวน 3 อัน แต่ละอันมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.5 มิลลิเมตร และยาว 3 มิลลิเมตร จัดวางห่างกันอันละ 1 เซนติเมตร และพันเส้นลวดส่วนที่เหลือ ไขว้กัน แล้วใส่ไว้ในหลอดแก้ว ดังรูป



รูปที่ 4.2.10 รูปวาดหัววัดสนามแม่เหล็ก[7]



รูปที่ 4.2.1<mark>1 แผนภาพแสดงการจั</mark>ดวางหัววัดสนามแม่เหล็ก



รูปที่ 4.2.12 ภาพการจัดวางหัววัดสนามแม่เหล็กในการทดลอง

จัดวางหัววัดสนามแม่เหล็กดังรูปที่ 4.2.11 โดยให้หัววัดสนามแม่เหล็กอันแรก ห่างจากขอบท่อ ควอทซ์เป็นระยะ 2 เซ็นติเมตร อันถัดมาจึงเป็น 3 และ 4 เซนติเมตรตามลำดับ สัญญาณจาก หัววัดสนามแม่เหล็กที่ออสซิลโลสโคปบันทึกไว้ได้ขณะเกิดพลาสมาเป็นดังรูปที่



รูปที่ 4.2.13 ภาพสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กที่ออสซิลโลสโคป บันทึกได้ขณะเกิด พลาสมาเส้นที่ 1 บนสุดคือสัญญาณของกระแสไฟฟ้าจากขดลวดโรโกวสกี้ 2 ,3,4 คือ สัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กตัวที่ห่างจากขอบเป็นระยะ 2,3 และ 4 เซนติเมตร ตามลำดับ

ในขณะทำการทดลองเราจะกำหนดให้เครื่องออสซิลโลสโคปเริ่มทำการบันทึกเมื่อมี สัญญาณจากขดลวดโรโกวสกี้เข้ามาสูงถึงระดับ 10.8 โวลต์ซึ่งหมายถึงเมื่อประจุถูกปล่อยจาก ตัวเก็บประจุความจุสูง เนื่องจากพลาสมาชีทเคลื่อนที่เข้ามาตามแนวรัศมีจึงผ่านหัววัด สนามแม่เหล็กแต่ละอันที่เวลาต่างกัน สัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กเมื่อเกิดพลาสมาจึง เกิดยอดจากการรบกวนของพลาสมาที่เวลาต่างกัน โดยอันที่อยู่ใกล้ขอบจะปรากฏก่อนตาม ด้วยอันถัดมา

จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย





จากรูปที่ 4.2.14 จะเห็นว่าเมื่อเกิดพลาสมาสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กจะปรากฏ ยอดชัดเจน ยอดที่ 1 ของหัววัดแต่ละอันปรากฏที่เวลาเดียวกัน ในขณะยอดที่ 2 ปรากฏที่เวลา เหลื่อมกันคือเริ่มต้นจากหัววัด 2, 3 และ 4 เซนติเมตรจากขอบตามลำดับ แต่พลาสมาเริ่มเกิดขึ้น เวลาไหนนั้นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ซิลิคอนพินไดโดด (BPX65) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจจับ แสงได้ตั้งแต่แสงความถี่ช่วงที่ตามองเห็นจนถึงความถี่ย่านรังสีเอ๊กซ์ โดยการใช้ซิลิคอนพินไดโอด ตรวจวัดสัญญาณพร้อมกับหัววัดสนามแม่เหล็กก็จะทำให้ทราบเวลาเริ่มต้นของการเกิดพลาสมา การต่อซิลิคอนพินไดโอดจะต้องทำการไบอัสลบให้กับไดโอด โดยมีวงจรดังรูปที่ 4.2.15 และต่อเข้ากับเครื่องพีไอซีพี ตรงแกนกลางของภาชนะสุญญากาศดังรูปที่ 4.2.16



รูปที่ 4.2.15 วงจรการต่อซิลิคอนพินไดโอด[7] เพื่อวัดแสงที่เกิดจากพลาสมา



รูปที่ 4.2.16 ภาพการติดตั้งซิลิคอนพินไดโอด

สัญญาณจากซิลิคอนพินไดโอดที่วัดพร้อมกับหัววัดสามแม่เหล็กแสดงดังรูปที่ 4.1.17



รูปที่ 4.2.17 ภาพแสดงสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กและซิลิคอนพินไดโอด

จากรูป การวัดในโตรเจนที่ 100 ปาสคาลเป็นการวัดขณะที่ไม่เกิดพลาสมา จึงไม่มี สัญญาณจากซิลิคอนพินไดโอด แต่เมื่อวัดขณะเกิดพลาสมาได้ปรากฏสัญญาณจากซิลิคอนพิน ใดโอด นั่นคือจุดที่มีแสงเกิดขึ้นหรือจุดเริ่มต้นของการเกิดพลาสมา และสัญญาณจากซิลิคอนพิน ไดโอดปรากฏตรงยอดที่ 1 ของสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กในทุกๆกราฟ เพราะฉะนั้นเรา สามารถใช้เวลาตรงยอดที่ 1 ของสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กเป็นจุดเริ่มของการเกิด พลาสมาได้





โดยการดูเวลาที่ปรากฏของยอดที่สองจากหัววัดสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งต่างๆก็สามารถ หาตำแหน่งในการเคลื่อนที่ของพลาสมาได้ และจากช่วงเวลาที่ต่างกันในช่วงระยะทาง 1 เซนติเมตรก็จะสามารถหาความเร็วเฉลี่ยในช่วงนั้นได้ ในที่นี้เราทำการวัดช่วงเวลาที่ต่างกันเฉพาะ ยอดที่สองหลังจากเริ่มเกิดพลาสมา และสามารถนำสัญญาณที่บันทึกขณะเกิดพลาสมาลบด้วย สัญญาณที่ทำการบันทึกขณะไม่เกิดพลาสมา (100 Pa) เพื่อให้สังเกตุยอดที่ทำการวัดง่ายขึ้น หาก ยอดที่จะทำการวัดนั้นปรากฏไม่ชัดเจน

จากรูป	เวลาขณะผ่านหัววัดอันแรก	คือ 6.00 X 10⁻⁵ วินาที
	เวลาขณะผ่านหัววัดอันที่สอง	คือ 6.05X10 ⁻⁵ วินาที
	เวลาขณะผ่านหัววัดอันที่สาม	คือ 6.11X10 ⁻⁵ วินาที
ห้าาัดต่ละต้าง	าางห่างกับ11ตบติเบตรเพรา~จ~บั้บ	ก็จะได้

ความเร็วเฉลี่ยระหว่างหัววัดตัวที่1 และ 2 คือ 0.01m / 0.05X10⁻⁵ s = 2.0x10⁴ m/s ความเร็วเฉลี่ยระหว่างหัววัดตัวที่ 2 และ 3 คือ 0.01m / 0.06X10⁻⁵s = 1.7x10⁴ m/s


รูปที่ 4.2.19 ภาพสัญญาณจากหัววัดสนามแม่เหล็กที่ปรากฏในออสซิลโลสโคป จากการเคลื่อนที่ของพลาสมาในโตรเจนภายในเครื่องพีไอซีพี

วิเคราะห็สัญญาณจากออสซิลโลสโคป จากรูปที่ 4.2.19 เป็นสัญญาณที่ได้จากการ ทดลอง ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับแบบจำลองทางทฤษฏีที่กล่าวว่าพลาสมาจะฟอร์มตัวเป็น แผ่นกระแสหมุนวนเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กด้านการเปลี่ยนแปลงจากกระแสภายนอก แล้ว เคลื่อนที่เข้ามาตามแนวรัศมีเนื่องจากแรงลอเรนต์ เมื่อพลาสมาชีทที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มี ประจุไฟฟ้า เคลื่อนที่ผ่านหัววัดสนามแม่เหล็ก ก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวภายใน ขดลวดของหัววัดสนามแม่เหล็ก การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กผ่านพื้นที่หน้าตัดหัววัด สนามแม่เหล็กเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของหัววัดเล็กมากและความเร็วของ พลาสมาน่าจะมีค่าสูง ลักษณะของสัญญาณจึงเป็นรูปไซน์ที่มีคาบสั้นและแอมปลิจูดสูงจนเกิด เป็นยอดตามรูป ความสูงของยอดบอกได้ถึงความเร็วของพลาสมาชีทขณะเคลื่อนที่ผ่านและ ปริมาณอนุภาคที่มีสนามแม่เหล็กจากพลาสมาโดยในขณะเคลื่อนที่ลึกเข้ามาก็จะกวาดเอาก๊าซที่ อยู่ด้านหน้าเขามาด้วยทำให้ความดันด้านหน้าพลาสมาชีทเพิ่มขึ้นความเร็วของพลาสมาจึงมี โอกาศลดลง พลาสมาชีทอาจกวาดก๊าซลึกเข้ามาถึงตำแหน่งหนึ่งที่อยู่นอกจุดวางหัววัด สนามแม่เหล็กจนความดันเพิ่มขึ้นและไม่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้อีก ความสูงของยอดเส้นที่สาม เมื่อนับจากเส้นบนนั้นจะสูงสุด แสดงให้เห็นว่าความเร็วพลาสมาน่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงแรกและข้าลง ในช่วงหลัง ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องพิสูจน์จากผลการทดลอง

การเกิดยอดหลังๆนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการเคลื่อนที่ของพลาสมาหรือจาก การสะท้อนของสัญญาณภายในวงจรของหัววัดเองในที่นี้การวัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของ พลาสมาจึงทำการวัดเฉพาะที่ยอดที่สองจากที่เกิดพลาสมา

 4.2.3 เครื่องสเปคโตรมิเตอร์ (Optical Emission Spectroscopy: OES)

 จากบทที่
 3 เราได้เรียนรู้ถึงที่มาของแสงที่แผ่ออกมาจากพลาสมา ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง

 การหาอุณหภูมิอิเล็กตรอน โดยอาศัยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ ซึ่งมีวิธีการจัดวางเครื่องมือดังรูปที่

 4.2.20



รูปที่ 4.2.20 ภาพการจัดวางเครื่องสเปคโตรสโคปีในการทดลอง

สเปคตรัมจากพลาสมาที่มีความยาวคลื่นต่างกันจะถูกแยกออกด้วยสเปคโตรกราฟ ภายในเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ และสัญญาณแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันจะถูกรับด้วยไดโอดรับแสง (Photodiod Array: PDA หรือ CCD) แล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแสดงผลออกมาเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและความเข้มแสงของความยาวคลื่นนั้นๆดังรูป



รูป4.2.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและความเข้มแสง จากสเปคตรัมของ ในโตรเจนพลาสมา ที่ความดัน 5 ปาสคาล กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีขนาด 1.4 กิโลจูล

สัญญาณที่เครื่องสเปคโตรมิเตอร์บันทึกเป็นดังรูปที่ 4.2.21 ซึ่งแสดงเป็นสัมพันธ์ของความ ยาวคลื่นและความเข้มในแต่ละความยาวคลื่นของรังสีที่แผ่ออกมาจากพลาสมา จากรูปแสดงให้ เห็นว่าของรังสีที่แผ่ออกมามีความยาวคลื่นไม่ต่อเนื่อง ความยาวคลื่นแสงที่แผ่ออกมาจาก พลาสมาเป็นลักษณะของการแผ่รังสีแบบเส้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงและความ หนาแน่นของโอกาสที่สถานะนั้น ของการแผ่รังสีแบบเส้นคือ[7]

$$I_{pq} = \frac{hc}{\lambda} A_{pq} N_p$$

$$4.11$$

A_{pq} คือโอกาสที่เกิดการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานที่ p ไปสู่ระดับชั้นที่ q เขียนสามการ4.11 เป็น

$$I_1 = \frac{hc}{\lambda_1} A_1 N_0^1 \tag{4.12}$$

และจากสมการ 3.6 ของแบบจำลองสมดุลอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่

$$N_0^1 = N_0 \frac{g_1}{U_0} \exp\left(-\frac{E_0}{kT_e}\right)$$
 4.13

เพราะฉะนั้นอัตราส่วนของความเข้มแสงเส้น 1 และ เส้น 2 คือ

$$R_{1} = \frac{I_{1}}{I_{2}} = \frac{A_{1}g_{1}\lambda_{2}N_{0}U_{1}}{A_{2}g_{2}\lambda_{1}N_{1}U_{0}} \cdot \exp\left(\frac{E_{2}-E_{1}}{kT_{e}}\right)$$

$$4.14$$

ในที่นี้ค่า λ_1 , λ_2 ก็คือความยาวคลื่นแสงที่มีความเข้มแสง I_1 และ I_2 ตามลำดับที่เรา เลือกจากกราฟ โดยจะต้องเลือกเส้นที่มีสถานะไอออนถัดกัน 1 สถานะ คือหากสเปคตรัมเส้นหนึ่ง มาจากไอออนสถานะ i อีกเส้นต้องมาจากไอออนสถานะ i+1(ในที่นี้คือ 0 กับ1นั่นเอง) ส่วนค่า Aและ g ซึ่งก็คือโอกาสที่เกิดการเปลี่ยนชั้นพลังงาน และตัวถ่วงน้ำหนักทางสถิติ รวมถึงสถานะของ ไอออนที่ความยาวคลื่นใดๆนั้นสามารถสืบค้นได้จากเวปไซต์ของ National Institute of Standards and Technology. (NIST) ส่วนค่า U_i และ N_i สามารถหาจากสมการที่ 3.7 และ 3.8 แต่จะเป็นการยุ่งยาก เราสามารถแก้ปัญหานี้โดยการเลือกสเปคตรัมอีกสองเส้นเป็น λ_3 และ λ_4 ที่มีความเข้ม I_3 และ I_4 ที่มีสถานะไอออนเป็น i และ i+1 เช่นเดียวกัน จากนั้นหาอัตราส่วน ของความเข้มของสองเส้นนี้ได้เป็น

$$R_{2} = \frac{I_{3}}{I_{4}} = \frac{A_{3}g_{3}\lambda_{4}N_{0}U_{1}}{A_{4}g_{4}\lambda_{3}N_{1}U_{0}} \cdot \exp\left(\frac{E_{4}-E_{3}}{kT_{e}}\right)$$

$$4.15$$

ทำการกำจัดตัวแปรทั้งสองที่เราไม่ทราบค่าก็จะได้เป็นสมการที่4.16[7]

$$R = \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_1}{I_2} \frac{I_4}{I_3} = \frac{A_1 A_4 g_1 g_4 \lambda_2 \lambda_3}{A_2 A_3 g_2 g_3 \lambda_1 \lambda_4} \cdot \exp\left(-\frac{E_1 - E_2 + E_4 - E_3}{kT_e}\right)$$
4.16

จากสมการนี้เราทำการเลือกสเปคตรัม 2 คู่ที่มีสถานะไอออนเป็น i และ i+1 เช่นเดียวกัน แล้วแทนค่าตัวแปรต่างๆ ที่นำมาจากเวบไซต์ดังกล่าวก็จะสามารถคำนวณค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอน ในรูปที่ติดค่าคงที่โบลทซ์มาน โดยมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ และทำการสร้างกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง R และ kT_e เพื่อนำค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนที่คำนวณได้มาเทียบกับเส้นโค้งที่ แสดงความสัมพันธ์นี้ โดยค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนที่คำนวณได้จะต้องอยู่ในช่วงความสัมพันธ์แบบ เส้นตรงของสัมพันธ์นี้ เนื่องจากขณะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอิเล็กตรอน ในช่วงเส้นตรงของ สัมพันธ์นี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่า R ที่ชัดเจน เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง R และ kT_e เพื่อให้เป็นช่วงในการเลือกอุณหภูมิอิเล็กตรอนที่คำนวณได้แสดงดังรูป 4.2.22



รูปที่ 4.2.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอิเล็กตรอนและค่า R[7]

สเปคโตรมิเตอร์ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นยี่ห้อ Ocean Optics รุ่น HR4C3461 สามารถ ตรวจรับความยาวคลื่นได้ตั้งแต่ 195.21 นาโนเมตรถึง 1128.57 นาโนเมตร สเปคตรัมของแสงที่มี ความยาวคลื่นนอกช่วงนี้จะไม่สามารถตรวจรับได้

ในการเก็บสัญญาณสเปคตรัมที่แผ่ออกมาจากพลาสมานั้น ได้ติดตั้งจุดรับแสงบริเวณ ด้านข้างตรงแกนกลางของท่อควอทซ์ เนื่องจากไม่สามารถเจาะท่อควอทซ์ เพื่อสร้างจุดติดตั้ง บริเวณด้านบนได้ สัญญาณสเปคตรัมที่แผ่จากพลาสมา ถูกส่งผ่านมาตามเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยการเก็บสัญญาณ ได้ทำการตั้งโปรแกรมให้เครื่องสเปคโตรมิเตอร์ ตัดสัญญาณของแสงปกติ ก่อนทำการทดลอง เพื่อที่ในขณะทำการทดลองสัญญาณที่รับจะได้เป็นสัญญาณของรังสีที่แผ่ ออกมาจากพลาสมาเท่านั้น ดังนั้นค่าที่ได้จึงเป็นความเข้มจากการแผ่รังสีของพลาสมาเพียงอย่าง เดียว การเก็บค่าสัญญาณสเปคตรัมทำการเก็บสัญญาณเป็นเวลา 0.1 วินาที โดยช่วงเวลา ดังกล่าวนี้ครอบคลุมช่วงเวลาที่เกิดพลาสมาทั้งหมด ซึ่งในการทำการทดลองได้ตั้งโปรแกรม ให้สเปคโตรมิเตอร์เริ่มต้นเก็บค่าเมื่อมีแสงจากพลาสมาเข้ามาเกิน 50 และเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ หยุดเก็บข้อมูลหลังจากเวลาผ่านไป 0.1 วินาที ซึ่งพลาสมาที่เกิดขึ้นภายในได้สลายตัวไปแล้ว จากนั้นนำสัญญาณที่ได้มาคำนวณหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนด้วยขั้นตอนตามแผนภาพดังรูป



รูปที่ 4.2.23 แผนภาพแสดงนั้นตอนการคำนวณหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอน ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดลองวัดการเคลื่อนที่ของพลาสมา และหาค่าอุณหภูมิ อิเล็กตรอน จากพลาสมาของก๊าซอาร์กอน ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซออกซิเจน ที่ความดัน 2, 3, 5, 7 และ10 ปาสคาล ที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพี โดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุขนาด 1.4, 2.4 และ 4.32 กิโลจูล และจากเครื่องที่ต้าพินซ์ที่มีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุขนาด 2.4 กิโลจูล เพื่อ สามารถเปรียบเทียบสมบัติของพลาสที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที่มีพลังสะสมในตัวเก็บประจุที่ น้อยกว่าเครื่องที่ด้าพินซ์ ที่ระดับพลังงานเดียวกับเครื่องที่ต้าพินซ์ และที่ระดับพลังงานสูงกว่า เครื่องที่ด้าพินซ์ตามลำดับ

64

บทที่ 5

การทดลองและผลการทดลอง

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ขดลวดโรโกวสกี้ใช้ในการวัดหากระแสไฟฟ้าที่ ไหลในวงจรของเครื่อง หัววัดสนามแม่เหล็กใช้หาตำแหน่งและความเร็วเฉลี่ยของพลาสมา และสเปคโตรมิเตอร์ใช้วัดหาอุณหภูมิอิเล็กตรอน แสดงเป็นแผนภาพในรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 แผนภาพการทดลองด้วยเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด

ขดลวดโรโกวสกี้ และหัววัดสนามแม่เหล็กที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสร้างขึ้น ก๊าซที่ใช้ ตลอดงานวิจัยนี้ประกอบด้วยก๊าซอาร์กอน ก๊าซออกซิเจน และก๊าซไนโตรเจน ความบริสุทธิ 99.99% สำหรับการทดลองเพื่อหากระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจรของเครื่องพีไอซีพีด้วยขดลวด โรโกสกี้นั้น ทำการทดลองทุกครั้งด้วยก๊าซไนโตรเจนที่ความดัน 100 ปาสคาลซึ่งเป็นความดันที่ไม่ เกิดพลาสมาภายในภาชนะสุญญากาศ ส่วนการทดลองเพื่อหาสมบัติของพลาสมาด้วยหัววัด สนามแม่เหล็กและเครื่องสเปคโตรมิเตอร์นั้นใช้ก๊าซทั้งสามชนิดที่ความดัน 2, 3, 5, 7 และ10 ปาสคาล โดยก่อนเริ่มทำทดลองและทุกครั้งหรือทำการเปลี่ยนชนิดก๊าซในขณะทำการทดลอง จะ ทำการปั๊มภาชนะสุญญากาศทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมงจนถึงความดันต่ำสุด จากนั้นทำการเติมก๊าซ ที่ต้องการทดลองแล้วปั๊มทิ้งจนถึงความดันต่ำอีกครั้งจำนวน 4 รอบ เพื่อให้ภายในภาชนะ สุญญากาศมีเฉพาะก๊าซที่ต้องการวัดผลบริสุทธิที่สุด และทำการเติมก๊าซใหม่ทุกครั้งขณะวัดผลแต่ ละค่า ค่าต่างๆที่แสดงในกราฟในบทนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการเก็บข้อมูลอย่างต่ำ 4 ครั้ง

5.1 การวัดค่ากระแสไฟฟ้าภายในวงจรของเครื่องพีไอซีพี

ในการทดลองนี้ได้ทำการบันทึกค่าเพิ่มเติมคือช่วงเวลาในการคายประจุจากตัวเก็บประจุ ดังรูปซึ่งก็คือค่าช่วงเวลาตั้งแต่ประจุเริ่มออกจากตัวเก็บประจุจนกระทั่งสัญญาณกลับมาเป็นศูนย์ อีกครั้ง สังเกตุได้จากสัญญาณจากขดลวดโรโกวสกี้ดังรูปที่ 5.2 ผลการทดลองหาค่าตัวแปร K แสดงดังตารางที่ 5.1



รูปที่ 5.2 รูปแสดงการวัดค่าความต่างศักย์และเวลาในสัญญาณที่ได้จากขดลวดโรโกวสกี้ที่วัดจาก วงจรเสมือนและแสดงการวัดเวลาการคายประจุจากตัวเก็บประจุในสัญญาณจากเครื่องพีไอซีพี ในที่นี้แสดงรูปร่วมกัน

			~~ ~~								
ครั้งที่	t1	v1	t2	v2	t3	v3	t4	v4	t5	v5	K (A/V)
1	3.03	6.80	3.62	7.80	4.20	5.20	4.78	5.72	5.36	3.88	593
2	1.08	6.60	1.68	7.76	2.25	5.00	2.84	5.36	3.42	3.64	606
3	3.53	6.60	4.13	7.68	4.70	5.08	5.29	5.52	5.86	3.84	611
4	4.29	6.56	4.88	7.44	5.46	4.76	6.04	5.20	6.63	3.44	607
5	0.87	6.56	1.46	7.64	2.04	5.00	2.62	5.48	3.19	3.72	618
6	4.13	6.72	4.71	7.80	5.29	5.24	5.87	5.64	6.44	3.88	605
							K	เฉลี่ย	607		
									S	.D.	8.21

ตารางที่ 5.1 แสดงผลการหาตัวแปร K ที่ได้จากวงจรเสมือน เวลาและความต่างศักย์ที่บันทึก มีหน่วยเป็น 10⁻⁵ วินาทีและโวลต์ตามลำดับ ตัวแปร K เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 607 แอมแปร์ต่อโวลต์โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.21 สามารถนำมาคำนวณหากระแสที่ไหลในวงจรของเครื่องพีไอซีพีได้ ผลการหากระแสที่ไหลใน วงจรและช่วงเวลาการคายประจุสำหรับการทดลองให้เครื่องพีไอซีพีทำงานที่พลังงาน 1.4, 2.4 และ 4.32 กิโลจูล แสดงดังตารางที่ 5.2

พลังงาน(J)		เวลาในการ ค่ายประจุ (μs)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	V1(ครั้งที่ 3	ั V) ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	เฉลี่ย	กระแสไฟฟ้า ที่ไหลใวงจร (kA)
PICP	1400	12.6	13.4	13.4	13.2	13.4	13.4	13.4	256
PICP	2400	12.7	17.6	17.4	17.6	17.4	17.6	17.5	336
PICP	4320	13.0	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	430
ThetaPir	nch2054	5.14	4.60	4.60	4.80	4.80	4.40	4.64	89.0
ThetaPinch2400		5.40	6.60	6.60	6.56	6.56	6.54	6.57	126
ThetaPir	nch3456	5.40	7.40	7.60	7.40	7.60	7.60	7.52	144

ตารางที่ 5.2 แสดงผลการหากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรและช่วงเวลาการคายประจุ จาก

เครื่องพีไอซีพีที่ทำงานโดยมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุขนาด 1.4, 2.4 และ4.32 กิโลจูล



รูปที่ 5.3 กราฟความสัมพันธ์ของพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

และกระแสไฟฟ้าที่ไหลใน_{วงจร}



รูปที่ 5.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุกับเวลาในการคายประจุ

พล้	เ ้งงาน	ความจุของ ตัวเก็บประจุ	ความต่างศักย์ที่จ่าย ให้กับตัวเก็บประจุ	ประจุที่สะสม ตามทฤษฎี	เวลาในการ คายประจุ
	(J)	(µ⊢)	(kV)	(mC)	(μS)
PICP	1400	60.0	6.83	410	12.6
PICP	2400	60.0	8.94	536	12.7
PICP	4320	60.0	12.0	720	13.0
Theta P	inch 20 <mark>5</mark> 4	12.0	18.5	222	5.14
Theta P	inch 2400	12.0	20.0	240	5.40
Theta P	inch 3456	12.0	24.0	288	5.40

ตารางที่ 5.3 รายละเอียดของตัวเก็บประจุจากเครื่องพีไอซีพีและเครื่องที่ต้าพินซ์

จากผลการทดลองเห็นได้ว่าเมื่อค่าความต่างศักย์ที่ให้กับตัวเก็บประจุความจุสูงของเครื่อง พีไอซีพีมีค่าเพิ่มขึ้น ค่ากระแสไฟฟ้าภายในวงจรที่วัดได้มีค่าเพิ่มขึ้น และกระแสในวงจรในเครื่อง พีไอซีพีอยู่ในระดับที่สูงกว่ากระแสไฟฟ้าภายในวงจรของเครื่องทีต้าพินซ์ เนื่องจากมีจำนวนประจุที่ สะสมในตัวเก็บประจุมีค่ามากกว่า เมื่อพิจารณาเวลาในการคายประจุในขณะที่ ค่าความต่างศักย์ ที่ให้กับตัวเก็บประจุของเครื่องพีไอซีพีมีค่าเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาในการคายประจุเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ช่วงเวลานี้ก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าเครื่องทีต้าพินซ์ การที่ช่วงเวลาในการคายประจุเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ถู่ต้าพินซ์สั้นกว่านั้น เกิดจากจำนวนประจุที่น้อยในขณะที่ความต่างศักย์มีค่ามาก ช่วงเวลาในการ คายประจุที่แตกต่างกันนี้ส่งผลให้ ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนั้นต่างกันดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.5 กราฟแสดงสัญญาณจากขดลวดโรโกวสกี้ ความสูงของสัญญาณ จากเครื่องที่ต้าพินซ์ที่มากกว่านั้นเกิดจากการใช้วงจรลดสัญญาณที่น้อยกว่า

ุ่นยวทยทรพยากร

ได้กล่าวมาแล้วว่าวงจรของเครื่องพีไอซีพีเป็นลักษณะของวงจร RLC และลักษณะของ สัญญาณของกระแสไฟฟ้าในวงจรที่ได้เป็นลักษณะของสัญญาณที่เป็นการแกว่งแบบถูกหน่วงซึ่ง คาบของกระแสเป็นไปตามความสัมพันธ์ $T = 2\pi\sqrt{LC}$ เมื่อแทนค่าคาบและค่าความจุของตัว เก็บประจุจากเครึ่งทั้งสองจะได้ $L_{picp} = 1.16L_{thetapinch}$ ทำให้ทราบว่าค่าความเหนี่ยวนำจากเครื่อง พีไอซีพีมีค่ามากกว่าเครื่องที่ต้าพินซ์

5.2 การวัดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในเครื่องพีไอซีพี

หัววัดสนามแม่เหล็ก 3 อัน ถูกจัดวางภายในท่อควอทซ์ตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง โดย หัววัดอันแรกอยู่ห่างจากผิวด้านในของท่อควอทซ์เป็นระยะ 2 เซนติเมตร ท่อควอทซ์มีรัศมีภายใน 5.46 เซนติเมตรตำแหน่งของหัววัดทั้งสามอันเมื่อวัดจากศูนย์กลางจึงเป็น 3.36, 2.46 และ1.46 เซนติเมตรที่ตำแหน่ง C, B และ A ตามลำดับ ตามรูปที่ 5.6





สำหรับท่อควอทซ์ของเครื่องที่ต้าพินซ์มีรัศมีภายใน 5.6 เซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่าท่อควอทซ์ จากเครื่องพีไอซีพีเล็กน้อยจุด และหัววัดสนามแม่เหล็กอันแรกถูกวางห่างจากผิวด้านในเป็นระยะ 2 เซนติเมตร จุด C, B และ A จึงห่างจากแกนกลางเป็นระยะ 3.6, 2.6 และ 1.6 เซนติเมตร ตามลำดับ

จากวิธีการที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 4 สามารถวัดเวลาการเคลื่อนที่ของพลาสมามาถึง ตำแหน่งที่จัดวางหัววัดสนามแม่เหล็กได้ แสดงดังตารางที่ 5.4 และแสดงความสัมพันธ์ของเวลาที่ มาถึงหัววัดกับระยะจุดศูนย์กลางท่อควอทซ์ของเครื่องพีไอซีพีขนาด1.4 กิโลจูลตามรูปที่ 5.7-5.10

ในงานวิจัยครั้งนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนในการจัดวางหัววัดสนามแม่เหล็กมีค่าไม่เกิน 0.1 เซนติเมตร ความคลาดเคลื่อนในการวัดเวลามีค่าเท่ากับ 0.01x 10⁻⁵ วินาที และความคลาดเคลื่อน ในการวัดความดันมีค่าไม่เกิน 0.2 ปาสคาล

	PICP 1.4 kJ					PICP 2.4 kJ			
ความ (ดันก๊าซ Pa)	ເວລາເນົ	มื่อมาถึงตำแ (10 ⁻⁵ s)	หน่งวัด	ความดันก๊าซ (Pa)		เวลาเมื่อมาถึงตำแหน่งวัด (10 ⁻⁵ s)		
		С	В	А		、	С	В	А
	2	0.37	0.41	0.47		2	0.34	0.38	0.43
	3	0.44	0.49	0.58		3	0.38	0.43	0.48
Ar	5	0.47	0.53	0.61	Ar	5	0.42	0.47	0.54
	7	0.52	0.58	0.81		7	0.48	0.53	0.61
	10	0.58	0.65	0.74		10	0.48	0.54	0.62
	2	0.35	0.38	0.43		2	0.34	0.37	0.42
	3	0.48	0.51	0.58		3	0.35	0.39	0.44
O_2	5	0.50	0.54	0.60	O_2	5	0.38	0.43	0.48
-	7	0.52	0.56	0.61		7	0.41	0.45	0.52
	10	0.53	0. <mark>59</mark>	0.65		10	0.41	0.47	0.52
	2	0.34	0.37	0.42	N ₂	2	0.28	0.31	0.35
	3	0.40	0.43	0.49		3	0.32	0.35	0.40
N_2	5	0.42	0.46	0.51		5	0.36	0.39	0.44
- 2	7	0.43 🧹	0.47	0.54		7	0.37	0.41	0.45
	8	0.45	0.49	0.55		10	0.49	0.53	0.58
		PICP 4.	32 kJ			Tł	neta Pinch	n (2.4 kJ)	
ความ	ดันก๊าซ	ເວລາເນົ	มื่อมาถึงตำแ (10-5)	หน่งวัด	ความ	มดันก๊าซ	เวลาเมื่อมาถึงตำแหน่งวัด		
(Pa)		(10°s)			(Pa)	(10 ⁻³ s)		
			B	A		-		B	A
	2	0.33	0.37	0.41		2	0.19	0.23	0.27
	3 5	0.34	0.38	0.43		<u>১</u>	0.22	0.26	0.30
Ar	5	0.36	0.41	0.47	Ar	5	0.26	0.30	0.35
	10	0.43	0.48	0.54		10	0.28	0.35	0.44
	10	0.53	0.56	0.00		10	0.20	0.34	0.43
	2	0.27	0.3	0.33		2	0.10	0.21	0.25
0	5 5	0.32	0.30	0.40	0	5	0.10	0.22	0.20
O_2	- 5 - 7	0.34	0.30	0.42	\mathbf{U}_2		0.20	0.24	0.29
	10	0.30	0.42	0.47		10	0.20	0.31	0.37
	2	0.39	0.44	0.49		2	0.24	0.29	0.30
	2	0.27	0.30	0.33	~ 0	2	0.22	0.20	0.29
N	5	0.20	0.31	0.34	N	5	0.20	0.20	0.33
112	7	0.32	0.35	0.39	112	7	0.25	0.21	0.32
		0.30	0.39	0.43			0.20	0.29	0.00
	10	0.38	0.42	0.46		10	0.26	0.30	0.35

และ1.46 เซนติเมตร จากจุดศุนย์กลางท่อควอทซ์



รูปที่ 5.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลางท่อ ควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซอาร์กอนในเครื่องพีไอซีพีขนาด 1.4 kJ



รูปที่ 5.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลางท่อ ควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซออกซิเจนในเครื่องพีไอซีพีขนาด 1.4 kJ



รูปที่ 5.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลางท่อ ควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซไนโตรเจนในเครื่องพีไอซีพีขนาด 1.4 kJ





จากความสัมพันธ์ในรูปที่ 5.7-5.10 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในก๊าซชนิดเดียวกันเมื่อ ความดันของก๊าซลดลงเวลาที่มาถึงหัววัดก็จะน้อยลง ความห่างของเวลาทั้งสองช่วงความบอกถึง ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ระหว่างสองช่วงตำแหน่งที่จัดวางหัววัดโดยเวลาช่วงแรกมีแนวโน้ม แคบกว่าช่วงที่สองแสดงถึงความเร็วในช่วงแรกมากกว่าในช่วงถัดมา ซึ่งสอดคล้องกับแบบจำลอง การเคลื่อนที่ของพลาสมาที่กล่าวว่า ในขณะพลาสมชีทมีการเคลื่อนที่เข้ามาจากผิวควอทซ์จะ กวาดเอาก๊าซที่อยู่ข้างหน้าเข้ามาตามแนวรัศมีด้วย ซึ่งความดันด้านหน้าพลาสมาชีทก็จะมากขึ้น ตามความลึกหรือตามระยะทางที่สั้นลงเมื่อวัดจากจุดศูนย์กลาง แรงต้านก็จะมีค่ามากขึ้น ตามลำดับ ความเร็วในช่วงที่สองจึงช้าลง และขณะที่ความดันลดลงแรงต้านดังกล่าวก็จะลดลง เช่นเดียวกัน

ความคลาดเคลื่อนในงานวิจัยครั้งนี้ ผลสำคัญเกิดมาจากการคายประจุออกจากตัวเก็บ ประจุความจุสูงของเครื่องพีไอซีพีนั้นมีปริมาณไม่เท่ากัน จะส่งผลต่อปริมาณกระแสที่ไหลในวงจร ต่างกันแรงลอเรนต์ที่เหนี่ยวนำให้พลาสมาเคลื่อนที่จึงต่างกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณต่างๆในงานวิจัยครั้งนี้

เมื่อพิจารณาที่พลังงานจากเครื่องพีไอซีพีและความดันเดียวกัน ของก๊าซทั้งสามชนิด พบว่าเวลาในเคลื่อนที่มาถึงหัววัดคือ ในโตรเจน <ออกซิเจน<อาร์กอน น่าจะเป็นผลมาจากมวล ของก๊าซที่แตกตัวเป็นพลาสมาโดยเมื่อพิจารณามวล ในโตรเจน<ออกซิเจน<อาร์กอน แสดงให้เห็น ว่าเมื่อมวลของก๊าซมากขึ้นเวลาในการเคลื่อนที่ก็จะช้าลง พิจารณาที่ความดันอื่นในการเคลื่อนที่ ของพลาสมาจากก๊าซทั้งสามชนิดก็มีแนวโน้มเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 5.11 กราฟแสดงเวลาในการ เคลื่อนที่มาถึงหัววัดณ.ตำแหน่ง 1.46 เซนติเมตร ผลในการวัดได้เวลาของอาร์กอนที่ต่ำกว่า ออกซิเจน ณ.ความดันที่ 3 และ 7 น่าจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่อยู่ภายใต้เหตุผลดังการ อธิบายที่ผ่านมา



รูปที่ 5.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงตำแหน่ง1.4 เซนติเมตรจากจุดศูนย์กลาง ท่อควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซสามชนิดในเครื่องพีไอซีพีขนาด 1.4 กิโลจูล

สำหรับเวลาที่ตำแหน่งหัววัดของเครื่องพีไอซีพีที่พลังงานอื่นๆแสดงดังรูปที่ 5.12-5.14



รูปที่ 5.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลางท่อ ควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซอาร์กอนในเครื่องพีไอซีพีพลังงานต่างๆที่ความดัน 2 ปาสคาล



รูปที่ 5.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มาถึงหัววัดและระยะจากจุดศูนย์กลางท่อ ควอทซ์ของพลาสมาจากก๊าซออกซิเจนในเครื่องพีไอซีพีพลังงานต่างๆที่ความดัน 2 ปาสคาล





จากผลการทดลองของเครื่องพีไอซีพีจะเห็นว่าเมื่อให้พลังงานจากตัวเก็บประจุมากขึ้น ระยะเวลาในการเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งที่วัดนั้นน้อยลงตามลำดับ แต่สำหรับเครื่องทีต้าพินซ์ซึ่งให้ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุเท่ากับเครื่องพีไอซีพีที่ 2.4 กิโลจูลใช้เวลาในการเคลื่อนที่มาถึงหัววัด น้อยกว่าเวลาของการเคลื่อนที่ของพลาสมาภายในเครื่องพีไอซีพีที่พลังงานต่างๆทั้งหมด เกิดจาก คาบของกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจรของเครื่องทีต้าพินซ์สั้นกว่าคาบของกระแสไฟฟ้าภายใน วงจรของเครื่องพีไอซีพี พลาสมาจึงถูกเร่งด้วยแรงลอเรนซ์ก่อนพลาสมาจากเครึ่งพีไอซีพี จากการทดลองที่ผ่านมาเราทราบเฉพาะเวลาในการเคลื่อนที่ของพลาสมาถึงตำแหน่งที่ จัดวางหัววัดสนามแม่เหล็กเท่านั้น ตำแหน่งของพลาสมาตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่สามารถวิเคราะห์ได้ จากแบบจำลองทางทฤษฎี

จากสมการ 3.21 ทำการกำหนดค่าตัวแปร m และแทนค่าตัวแปรเริ่มต้นในสมการแล้วทำ การคำนวณ นำกระแสที่ได้ที่ได้มาเทียบกับผลการทดลองตามรูป 5.15

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าในวงจรและเวลา ผลจากแบบจำลองทางทฤษฎี และผลการทดลองยังไม่สอดคล้องกัน จากนั้นทำการปรับเปลี่ยน ค่าตัวแปรเริ่มต้น m ที่กำหนดขึ้นจนผลที่ได้จากแบบจำลองและผลการทดลองสอดคล้องกันดังรูป ที่ 5.16



รูปที่ 5.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าในวงจรและเวลาหลังจากการปรับค่าตัวแปร

นำค่า m มาใช้ในสมการ 3.38 และแทนค่าตัวแปรต่างๆ แล้วทำการปรับเปลี่ยนค่า f_m จนผลที่ได้ จากแบบจำลองทางทฤษฎีสอดคล้องกับการทดลอง ก็จะได้ตำแหน่งของพลาสมาที่เวลาต่างๆดัง รูปที่ 5.17 – 5.19



รูปที่ 5.17กราฟแสดงตำแหน่งของพลาสมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีและจากการทดลองของ พลาสมาจากก๊าซอาร์กอนที่ความดัน 2 ปาสคาล จากเครื่องพีไอซีพี ขนาด 1.4 กิโลจูล



รูปที่ 5.18 กราฟแสดงตำแหน่งของพลาสมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีและจากการทดลองของ พลาสมาจากก๊าซอ๊อกซิเจนที่ความดัน 5 ปาสคาล จากเครื่องพีไอซีพี ขนาด 2.4 กิโลจูล



รูปที่ 5.19 กราฟแสดงตำแหน่งของพลาสมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีและจากการทดลอง ของ พลาสมาจากก๊าซไนโตรเจนที่ความดัน 2 ปาสคาล จากเครื่องพีไอซีพี ขนาด 1.4 กิโลจูล

จากแบบจำลองทางทฤษฏีด้วยการปรับค่าตัวแปร m ในสมการวงจรให้สอดคล้องกับ กระแสภายในวงจรขณะเกิดพลาสมาในช่วงที่เราทำการวัด และปรับ ค่า f_m ในแบบจำลองการ เคลื่อนที่ของพลาสมา ผลจากแบบจำลองทางทางทฤษฏีแสดงการเคลื่อนที่ของพลาสมาจากผิว ควอทซ์ (ระยะ 1 ในแกนตั้งคือระยะเริ่มต้นการเคลื่อนที่หรือที่ผิวด้านในของท่อควอทซ์) ผลจาก แบบจำลองทำให้เห็นว่าพลาสมาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถึงศูนย์กลางโดยความเร็วของพลาสมามี แนวโน้มเร็วขึ้นในช่วงแรกและซ้าลงเมื่อใกล้ถึงศูนย์กลาง และพบว่าก๊าซไนโตรเจนสามารถ เคลื่อนที่เข้าไปได้ลึกสุดตามแนวรัศมีตามด้วยออกซิเจน และอาร์กอน ซึ่งเกิดจากมวลโมเลกุลที่ น้อยกว่าตามลำดับ ผลที่ได้จากแบบจำลองทฤษฏีมีแนวโน้มสอดคล้องกับการทดลองที่ได้วัด ในช่วงระยะสั้นๆ

ในแบบจำลองทางทฤษฎีได้กำหนดตัวแปรเริ่มต้นให้เป็นไปตามอุดมคติเช่น กำหนดให้ ก๊าซทุกโมเลกุลแตกตัวเป็นพลาสมาหมดเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ ความจริงก๊าซทุกโมเลกุลอาจ ไม่แตกตัวหมด จึงทำให้ผลที่ได้จากแบบจำลองทางทฤษฎีมีโอกาศคลาดเคลื่อนจากความจริงและ เป็นสาเหตุของความแตกต่างของระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของพลาสมาช่วงแรกที่ได้จาก แบบจำลองทางทฤษฎีและจากการทดลอง

ที่ผ่านมาเราได้ทราบเพียงแค่เวลาของพลาสมาเมื่อเคลื่อนถึงตำแหน่ง 3.46, 2.46 และ 1.46 เซนติเมตร จากผลต่างของเวลาที่ผ่านมาถึงตำแหน่งดังกล่าว เราสามารถหาวามเร็วเฉลี่ย ของพลาสมาระหว่างสองช่วงนี้ได้ แสดงดังตารางที่ 5.5

PICP 1.4 kJ.					PICP 2.4 kJ.				
ความ	เดันก๊าซ D-\	ความเร็วเฉลี่	ย(x10 ⁴ m/s)	ความดันก๊าซ (Do)		ความเร็วเฉลี	ย(x10 ⁴ m/s)		
(Pa)		3.46 - 2.46	2.46 -1.46	(Pa)	3.46 - 2.46	2.46 - 1.46		
	2	2.4	1.9		2	2.5	2.3		
	3	2.2	1.1		3	2.3	1.8		
Ar	5	1.7	1.3	Ar	5	2.3	1.3		
	7	1.6	0.8		7	2.1	1.3		
	10	1.4	1.2		10	1.6	1.3		
	2	3.5	2.0		2	3.8	2.0		
	3	3.3	1.6		3	2.7	2.0		
O ₂	5	2.7	1.7	O_2	5	2.3	1.9		
- 2	7	2.6	2.0	- 2	7	2.5	1.6		
	10	1.8	1.5		10	1.8	1.8		
	2	4.2	1.8		2	4.2	2.5		
	3	3.8	1.7		3	3.8	2.0		
N_2	5	2.7	1.8	N_2	5	3.3	2.3		
- • 2	7	2.6	1.5	2	7	2.9	2.9		
	8	2.4	1.9		10	2.6	2.0		
F									
	F	PICP 4.32 kJ	. / / 🦉 🖓		The	ta Pinch(2.4	kJ)		
ความ	ไ ดันก๊าซ	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี	งีย(x10 ⁴ m/s)	ความ	The เดันก๊าซ	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่	<mark>kJ)</mark> ย(x10 ⁴ m/s)		
ความ (ิโ ดันก๊าซ Pa)	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46	รัย(x10 ⁴ m/s) 2.46 -1.46	ความ (The เดันก๊าซ Pa)	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6	<mark>kJ)</mark> ย(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6		
ความ (โ	F เดันก๊าซ Pa) 2	PICP 4.32 kJ ความเร็วเลลี 3.46 - 2.46 2.9	งีย(x10 ⁴ m/s) 2.46 -1.46 2.5	ความ (The เดันก๊าซ Pa) 2	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9	kJ) ຢ(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4		
ความ (ศั ดันก๊าซ Pa) <u>2</u> 3	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5	ชัย(x10 ⁴ m/s) 2.46 -1.46 2.5 1.9	ความ (The เดันก๊าซ Pa) <u>2</u> 3	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7	kJ) ध(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3		
ความ (I	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8	ความ (Ar	The เด้นก๊าซ Pa) 2 3 5	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5	kJ) ٤(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1		
ความ (I	ศันก๊าช Pa) <u>2</u> <u>3</u> 5 7	PICP 4.32 kJ ความเร็วเลลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7	ความ (Ar	The เดันก๊าช Pa) 2 3 5 7	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5	kJ) ध(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2		
ดวาม (I Ar	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4	ຄວາມ (Ar	The เดันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3	kJ) El(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 1.2		
ความ (I Ar	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 3.8	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1	ความ (Ar	The เด้นก๊าช Pa) 2 3 5 7 10 2	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5	kJ) ٤(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4		
ความ (I	ศันก๊าช Pa) 2 3 5 7 10 2 3	PICP 4.32 kJ ความเร็วเลลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 3.8 2.9	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5	ความ (Ar	The เดันก๊าช Pa) 2 3 5 7 10 2 3	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1	kJ) ٤(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4 2.4 2.1		
ความ (I Ar O ₂	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 5	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 1.9 3.8 2.9 2.7	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5 2.3	ความ (Ar O ₂	The เดันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 3 5	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1 2.5	kJ) EI(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 1.2 2.4 2.1 2.1 2.0		
ความ (I Ar O ₂	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 3 5 7	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 3.8 2.9 2.7 2.5	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5 2.3 2.0	ความ (Ar O ₂	The เด้นก๊าช Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 5 7	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1 2.5 2.3	kJ) El(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4 2.4 2.1 2.0 1.7		
ความ (I Ar O ₂	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 7 10	PICP 4.32 kJ ความเร็วเลลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 1.9 3.8 2.9 2.7 2.5 2.3	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5 2.3 2.0 1.9	ความ (Ar O ₂	The เดันก๊าช Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 5 7 10	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1 2.5 2.3 2.0	kJ) ٤(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4 2.1 2.0 1.7 1.6		
ความ ((Ar O ₂	ศึนก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 10 2	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 1.9 3.8 2.9 2.7 2.5 2.3 5.0	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5 2.3 2.0 1.9 3.1	ความ (Ar O ₂	The เด้นก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 10 2	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1 2.5 2.3 2.0 3.8	kJ) EI(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4 2.1 2.0 1.7 1.6 2.3		
ความ (I Ar O ₂	ศึนก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 3	PICP 4.32 kJ PICP 4.32 kJ PICP 4.32 kJ 2.10 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 1.9 3.8 2.9 2.7 2.5 2.3 5.0 4.2	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5 2.3 2.0 1.9 3.1 2.9	ความ (Ar O ₂	The เด้นก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 10 2 3	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1 2.5 2.3 2.0 3.8 3.1	kJ) El(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4 2.1 2.4 2.1 2.0 1.7 1.6 2.3 2.3		
ความ (I Ar O ₂	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 5	PICP 4.32 kJ PICP 4.32 kJ 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 3.8 2.9 2.7 2.5 2.3 5.0 4.2 3.3	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5 2.3 2.0 1.9 3.1 2.9 2.6	פרנ א (Ar O ₂	The เด้นก้าช Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 5 5	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1 2.5 2.3 2.0 3.8 3.1 2.8	kJ) El(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4 2.1 2.0 1.7 1.6 2.3 2.3 2.1		
ความ ((Ar O ₂	ศันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 7 7 10 2 3 7 7	PICP 4.32 kJ ความเร็วเฉลี 3.46 - 2.46 2.9 2.5 2.0 1.9 1.9 1.9 3.8 2.9 2.7 2.5 2.3 5.0 4.2 3.3 2.9	2.46 -1.46 2.5 1.9 1.8 1.7 1.4 3.1 2.5 2.3 2.0 1.9 3.1 2.9 2.6 2.4	ארכא (Ar O ₂ N ₂	The เดันก๊าซ Pa) 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 7 10 2 3 5 7 7	ta Pinch (2.4 ความเร็วเฉลี่ 3.6 - 2.6 2.9 2.7 2.5 1.5 1.3 3.5 3.1 2.5 2.3 2.0 3.8 3.1 2.8 2.8	kJ) El(x10 ⁴ m/s) 2.6 - 1.6 2.4 2.3 2.1 1.2 1.2 2.4 2.1 2.0 1.7 1.6 2.3 2.3 2.1 1.7		

ตารางที่ 5.5 แสดงผลการหาความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาระหว่างตำแหน่ง

3.46 ถึง 2.46 เซนติเมตร และ 2.46 ถึง1.46 เซนติเมตร

ข้อมูลในตารางที่ 5.5 แสดงให้เห็นว่าที่การทดลองเดียวกันความเร็วเฉลี่ยในช่วง 3.46 – 2.46 จะมีค่ามากกว่า 2.46-1.46 สอดคล้องกับแนวโน้มในตารางที่ 5.4 และดูได้จากตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของความเร็วเฉลี่ยที่ทั้งสองตำแหน่งในรูปที่ 5.20 และ ในก๊าซชนิดเดียวกันพลังงาน เท่ากันความดันที่มากขึ้นส่งผลให้ความเร็วเฉลี่ยน้อยลงดูได้จากตัวอย่างของความสัมพันธ์ของ ความเร็วเฉลี่ยและความดันจากเครื่องพีไอซีพีที่พลังงาน 1.4 และ4.32 กิโลจูลตามรูปที่ 5.21-5.22 ตามลำดับ







รูปที่ 5.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉลี่ยของพลาสมา และความดันของก๊าซทั้งสามจากเครื่องพีไอซีพีขนาด 1.4 กิโลจูล



รูปที่ 5.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉลี่ยของพลาสมา และความดันของก๊าซทั้งสามจากเครื่องพีไอซีพีขนาด 4.32 กิโลจูล

 จากรูปที่
 5.20 เมื่อพลังงานจากตัวเก็บประจุมีค่ามากขึ้นความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาก็จะ มากขึ้น เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรมีค่ามากขึ้นเหนี่ยวนำให้เกิดแรงกระทำต่อพลาสมาชีท มากขึ้นนั่นเอง ข้อมูลในตารางและตัวอย่างความสัมพันธ์ในรูปที่
 5.21และ5.22 พบว่าในการหา ความเร็วเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของพลาสมาชีทจากก๊าซไนโตรเจนมีค่ามากสุด จากนั้นเป็นออกซิเจน และอาร์กอนตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบมวล โมเลกุลตามชนิดของก๊าซพบว่าการที่มีมวลโมเลกุล น้อยกว่ามีความเร็วสูงสุดมากกว่า [1]

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดของพลาสมาจากเครื่องที่ต้าพินซ์ซึ่งมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 2.4 กิโลจูลนั้น พบว่าความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาจากก๊าซไนโตรเจนมีค่าน้อยกว่าจากเครื่องพีไอซี พีทุกระดับพลังงาน ส่วนพลาสมาจากก๊าซออกซิเจนมีค่าใกล้เคียงกับเครื่องพีไอซีพีที่ 1.4 กิโลจูล และสำหรับอาร์กอนใกล้เคียงกับเครื่องพีไอซีพีที่ 4.32 กิโลจูล แม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่วัดจาก ขดลวดโลโกวสกี้จะมีค่าน้อยสุดแต่ความเร็วสูงสุดของพลาสมาชีท ก็มีค่าไม่ได้น้อยกว่ามาก มีค่า ค่อนข้างใกล้เคียงกับของเครื่องพีไอซีพีที่แต่ละระดับพลังงาน และไม่สามารถสรุบได้ว่าความเร็ว เฉลี่ยของพลาสมาชีทจากเครื่องพีไอซีพีที่แต่ละระดับพลังงาน และไม่สามารถสรุบได้ว่าความเร็ว เฉลี่ยของพลาสมาชีทจากเครื่องทีต้าพินซ์นั้นอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องพีไอซีพีที่ 2.4 กิโลจูล ทั้งนี้ น่าจะเกิดจากคาบของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรของเครื่องทีต้าพินซ์ที่สั้นกว่า ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดในการวัดในงานวิจัยนี้เป็นความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาชีทจากก๊าซ ไนโตรเจนกำเนิดจากเครื่องพีไอซีพี วัดได้ 5.0x10⁴ เมตรต่อวินาที ซึ่งทำการวัดในช่วง 3.46 ถึง

2.46 เซนติเมตรจากแกนกลาง

5.3 การวัดค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนภายในเครื่องพีไอซีพี

ผลจากการวัดค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนด้วยวิธีการในบทที่ 4 ของก๊าซอาร์กอน ก๊าซ ในโตรเจน และก๊าซออกซิเจน ด้วยเครื่องพีไอซีพีที่พลังงาน 1.4, 2.4 และ 4.2 กิโลจูล และด้วย เครื่องทีต้าพินซ์ แสดงดังตารางที่ 5.6-5.8

ความดัน	อุณหภูมิอิเล็กตรอน(eV)							
(Pa)	พีไอซีพี 1. <mark>4 kJ</mark> .	พีไอซีพี 2.4 kJ	พีไอซีพี 4.32 kJ.	ทีต้าพินช์ 2.4 kJ				
2	0.89	1.61	3.92	0.38				
3	1.69	2.49	3.60	12.7				
5	1.49	1.36	2.33	5.29				
7	0.75	0.87	0.74	0.83				
10	0.87	1.22	0.62	0.06				

ตารางที่ 5.6 แสดงผลการหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจากก๊าซอาร์กอน

ความดัน	<mark>อุณหภู</mark> มิอิเล็กตรอน(eV)							
(P_{2})	พีไอซีพี	พีไอซีพี	พีไอซีพี	ที่ต้าพินช์				
(14)	1.4 kJ.	2.4 kJ	4.32 kJ.	2.4 kJ				
2	7.31	11.6	10.2	6.90				
3	5.22	16.9	6.91	6.92				
5	6.62	6.18	7.59	3.56				
7	5.84	6.01	5.44	3.61				
10	4.21	3.63	5.39	3.75				

ตารางที่ 5.7 แสดงผลการหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจากก๊าซไนโตรเจน

1	ความดัน	อุณหภูมิอิเล็กตรอน(eV)							
	(Pa)	พีไอซีพี	พีไอซีพี	พีไอซีพี	ที่ต้าพินช์				
	(* -1)	1.4 kJ.	2.4 kJ	4.32 kJ.	2.4 kJ				
	2	21.7	14.7	0.86	1.07				
	3	0.93	6.03	19.7	1.27				
	5	0.57	0.27	3.43	0.18				
	7	0.46	0.27	0.39	0.17				
	10	0.47	0.27	0.41	0.17				

ตารางที่ 5.8 แสดงผลการหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจากก๊าซอ๊อกซิเจน

จากข้อมูลอุณหภูมิอิเล็กตรอนในตารางที่ 5.6 – 5.8 สามารถแสดงเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอน แสดงในรูปที่ 5.23 -5.29



รูปที่ 5.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนจากเครื่องพีไอซีพีที่ ทำงา<mark>นโดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บป</mark>ระจุ 1.4 กิโลจูล



รูปที่ 5.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนจากเครื่องพีไอซีพีที่ ทำงานโดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 2.4 กิโลจูล



รูปที่ 5.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนจากเครื่องพีไอซีพีที่ ทำงานโดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 4.32 กิโลจูล



รูปที่ 5.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนจากเครื่องที่ต้าพินซ์ ที่ทำงานโดยใช้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 2.4 กิโลจูล



รูปที่ 5.27 กราฟแสดงควา<mark>มสัมพันธ์ระ</mark>หว่า<mark>ง</mark>ควา<mark>มดันและอุณ</mark>หภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจาก ก๊าซอาร์<mark>กอนที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที และ</mark>เครื่องทีต้าพินช์



รูปที่ 5.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจาก ก๊าซไนโตรเจนที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที และเครื่องทีต้าพินซ์



รูปที่ 5.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมาจาก ก๊าซอ๊อกซิเจนที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพีที และเครื่องทีต้าพินซ์

จากผลการทดลองวัดค่าอุณหภูมอิเล็กตรอนด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์นั้น พบว่าที่ พลังงานในการกำเนิดพลาสมาเดียวกัน เมื่อความดันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิอิเล็กตรอนมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเกิดจากขณะความดันเพิ่มขึ้นจำนวนอนุภาคในพลาสมามีจำนวนมากขึ้นพลังงานเฉลี่ยต่อ จำนวนจึงมีค่าน้อยลง ในช่วง 5 -10 ปาสคาลอุณหภูมิอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงไม่มาก ในขณะที่ ในช่วง 2-5 ปาสคาลเมื่อความดันลดลงอุณหภูมิอิเล็กตรอนมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ในช่วง 5 -10 ปาสคาลนั้น พลังงานส่วนใหญ่ที่ให้กับก๊าซใช้ไปกับการทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นพลาสมาและเมื่อ ความดันลดลงในช่วง 2-5 ปาสคาลนั้นพลังงานที่ให้นอกจากเพียงพอทำให้ก๊าซแตกตัวเป็น พลาสมาแล้ว ยังไปเร่งพลาสมาอีกด้วย ทำให้อุณหภูมิอิเล็กตรอนมีค่ามากขึ้น ที่ความดันสูง ในโตรเจนจะมีอุณหภูมิอิเล็กตรอนสูงสุด เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ที่ให้ไปถูกใช้ไปในการเร่งให้ พลาสมาเคลื่อนที่[1] และเมื่อพิจารณารูปที่ 5.28-5.29 ช่วงที่อุณภูมิของพลาสมาเปลี่ยนแปลงไม่ มากนั้นพลาสมาจากเครื่องที่ต้าพินซ์มีค่าต่ำสุดทั้งนี้น่าจะเกิดจากปริมาตรของก๊าซมีมากกว่า เครื่องพีไอซีพีที่ความดันเดียวกันพลังงานส่วนใหญ่จึงไปเฉลี่ยให้กับจำนวนอนุภาคที่มีจำนวน มากกว่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนจึงมีค่าน้อยกว่าเครื่องพีไอซีพี

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงความดัน 2-3 ปาสคาลพบว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ อิเล็กตรอนกลับเพิ่มขึ้น และที่ความดันเดียวกันกลับพบว่าเมื่อพลังงานที่ให้มีค่ามากขึ้นอุณหภูมิ อิเล็กตรอนกลับมีค่าลดลง ซึ่งคือข้อขัดแย้งสำคัญ และผลที่ได้นี้ขัดแย้งกับคำอธิบายข้างต้น ทั้งนี้ เพราะน่าจะเป็นผลมาจาก โฟตอนส่วนใหญ่ที่แผ่ออกมาจากพลาสมาอาจอยู่นอกช่วงที่เครื่อง สเปคโตรมิเตอร์ที่สามารถรับความยาวคลื่นตั้งแต่ 195.21 นาโนเมตรถึง 1128.57 นาโนเมตร ตรวจรับได้ ความยาวคลื่นที่เลือกมาคำนวณค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนจึงไม่ใช่ตัวแทนของโฟตอนที่ แผ่จากพลาสมาส่วนใหญ่ ซึ่งคำอธิบายดังกล่าวค่อนข้างสอดคล้องกับผลการทดลองจริงเนื่องจาก เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ที่ความดันต่ำกว่า 1 ปาสคาล ขณะที่สังเกตุเห็นพลาสมา ได้อย่างชัดเจน และสามารถจับการเคลื่อนที่ของพลาสมาได้จากหัววัดสนามแม่เหล็ก เครื่องสเปค โตรมิเตอร์กลับไม่สามารถจับสัญญาณได้เลย คำตอบที่ถูกต้องยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมากต่อไป การวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ในงานวิจัยครั้งนี้จึงยังไม่ไม่เพียงพอที่จะ กล่าวว่าค่าที่ได้แทนพลังงานของพลาสมาโดยรวมที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพี

และจากแบบจำลองทางทฤษฎีสามารถใช้สมการ 3.39 ใช้เพื่อหาอุณหภูมิอิเล็กตรอนที่ แปรผันตามเวลา โดยทำการเลือกค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนสูงสุดมาแสดงดังรูป 5.30-5.32



รูปที่ 5.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ พลาสมาจากก๊าซอาร์กอนของเครื่องพีไอซีพีที่ได้จากแบบจำลอง





รูปที่ 5.31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ พลาสมาจากก๊าซออกซิเจนของเครื่องพีไอซีพีที่ได้จากแบบจำลอง



รูปที่ 5.32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิอิเล็กตรอนของ พลาสมาจากก๊าซไนโตรเจนของเครื่องพีไอซีพีที่ได้จากแบบจำลอง

ผลจากแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ้นค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนมีแนวโน้ม ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนที่ได้จากแบบจำลองทางทฤษฎีไม่สามารถ เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลองเนื่องจากการคำนวณค่าโดยเลือกค่าความเข้มและความ ยาวคลื่นแสงที่บันทึกจากเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ที่ทำการบันทึกสัญญาณรวมตลอดช่วงที่เกิด พลาสมา แต่จากแบบจำลองเป็นอุณหภูมิอิเล็กตรอนที่ขณะเวลาใดๆ แล้วทำการเลือกค่าสูงสุดซึ่ง เป็นค่าที่เกิดขึ้นเมื่อพลาสมาเคลื่อนที่เข้ามาลึกสุดจนมีความหนาแน่นสูงสุด มาแสดงเป็นกราฟที่ ผ่านมา แต่ขณะเดียวกันแนวโน้มที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้ว่าที่ความดันสูงพลังงานที่ให้ไปส่วน ใหญ่ใช้ไปในการทำให้ก๊าซแตกตัวและที่ความดันต่ำลงพลังงานที่ให้ยังใช้ไปในการเร่งพลาสมาอีก ด้วยอุณหภูมิอิเล็กตรอนจึงมีค่าสูงขึ้น[1]



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 6 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

วิทยานิพนธ์นี้ได้ทำการสร้างเครื่องพีไอซีพี และทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของเครื่อง ้คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจรของเครื่อง และทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของพลาสมาที่ ้กำเนิดจากเครื่อง คือความเร็วของพลาสมาและอุณหภูมิอิเล็กตรอน จากนั้นทำการเปรียบเทียบผล การทดลองที่ได้จากเครื่องดังกล่าวกับผลจากเครื่องที่ต้าพินซ์และผลจากแบบจำลองทางทฤษภู ้สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวง<mark>จรเป็นสิ่งที่สำคัญ</mark> เพราะเป็นตัวเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก เพื่อทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นพลาสมา และกระแสไฟฟ้ายังใช้เป็นตัวเปรียบเทียบหลักในการพิสูจน์ ของแบบจำลองทางทฤษฎี ซึ่งค่ากระแสไฟฟ้านี้ทำการวัดด้วยขดลวดโรโกวสกี้ จากการทดลอง พบว่า เมื่อพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุของเครื่องพีไอซีพีมีค่ามากขึ้นกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จาก ้วงจรก็มีค่ามากขึ้นและอยู่ในระดับที่สูงกว่ากระแสไฟฟ้าที่วัดด้วยวิธีการเดียวกันจากเครื่อง ที่ต้าพินซ์ เครื่องพี่ไอซีพีที่มีตัวเก็บประจุความจุสูงขนาด 60 ไมโครฟารัด ทำการซาร์จประจุให้ ้เครื่องพี่ไอซีพีทำงานขณะมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุเป็น 1.4, 2.4 และ 4.32 กิโลจูล สามารถ วัดค่ากระแสไฟฟ้าในการทดลอง ได้เท่ากับ 256, 336, 430 กิโลแอมแปร์ ตามลำดับ และสำหรับ เครื่องที่ต้าพินซ์ที่มีตัวเก็บปร<mark>ะจุคว</mark>ามจุสูงขนาด 12 ไมโครฟารัด และ ชาร์จประจุให้เครื่งทำงาน ขณะมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ เป็น 2.1, 2.4, 3.5 <mark>กิ</mark>โลจูล วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้ ้เท่ากับ 89, 126, 144 กิโลแอมแป<mark>ร์ตามลำดับด้วยขดลว</mark>ดโรโกวสกี้อันเดียวกัน ที่มี อัตราส่วนของ กระแสไฟฟ้าสูงสุดกับความต่างศักย์สูงสุดค่าแรกที่วัดได้ มีค่าเป็น 607 แอมแปร์ต่อโวลต์ เวลา การคายประจุเฉลี่ยสำหรับเครื่องพีไอซีพีอยู่ที่ 12.6 ถึง13 ไมโครวินาที และสำหรับเครื่องที่ต้าพินซ์ อยู่ที่ 5.14 ถึง 5.4 ไมโครวินาที พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสะสมประจุใน ้ตัวเก็บประจุความจุสูงที่มากขึ้น เมื่อถูกปลดปล่อยออกมาจากตัวเก็บประจุในช่วงเวลาใกล้เคียง กันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นตามมา ค่ากระแสไฟฟ้าและเวลาการคายประจุของเครื่องพีไอซี พีที่มากกว่าเครื่องที่ต้าพินช์นั้น เป็นผลเนื่องมาจากปริมาณประจุในตัวเก็บประจุที่มากกว่า นอกจากนี้เวลาการคายประจุที่มากกว่ายังส่งผลให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจรของ เครื่องพีไอซีพีมากกว่าเครื่องที่ต้าพินซ์ด้วย

สำหรับการศึกษาสมบัติของพลาสมาที่กำเนิดจากเครื่องพีไอซีพี ได้ ทำการทดลองวัดการ เคลื่อนที่ของพลาสมาด้วยหัววัดสนามแม่เหล็ก และ หาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนด้วยเครื่องสเปคโตร มิเตอร์ จากพลาสมาของก๊าซอาร์กอน ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซออกซิเจน ที่ความดัน 2, 3, 5, 7 และ10 ปาสคาล โดยทำการวัดขณะเครื่องพีไอซีพีทำงานโดยมีพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ ขนาด 1.4, 2.4 และ 4.32 กิโลจูล พบว่าพลังงานในเครื่องพีไอซีพีที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ความเร็วของ พลาสมามีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนำให้ เกิดสนามแม่เหล็กมีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงลอเรนต์ซึ่งเป็นตัวเร่งให้พลาสมาเคลื่อนที่มีค่ามาก ขึ้นด้วย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นนอกจากถูกใช้ไปในการทำให้ก๊าซแตกตัว เป็นพลาสมาแล้วยังใช้ในการเร่งให้พลาสมาเคลื่อนที่ ดังนั้นเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นจึงมีพลังงาน สำหรับการเร่งมากขึ้น

จากการทดลองพบว่าเมื่อความดันมีค่าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของ พลาสมาลดลง เนื่องจากความดันที่มากขึ้นเกิดจากปริมาณก๊าซที่มากขึ้น พลังงานส่วนใหญ่จึงถูก ใช้ในการทำให้ก๊าซแตกตัว จึงเหลือพลังงานสำหรับการเร่งพลาสมาน้อยลง[1] ขณะที่การเคลื่อนที่ ของพลาสมาเป็นลักษณะของพลาสมาชีทกวาดก๊าซที่ยังไม่แตกตัวเข้ามาตามแนวรัศมี เมื่อมีก๊าซ ปริมาณมากขึ้นความดันของก๊าซที่ถูกกวาดเข้าก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ ของพลาสมาช้าลง โดยความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของพลาสมาจากก๊าซไนโตรเจนมีความเร็ว มากสุด ตามด้วยออกซิเจน และอาร์กอนมีค่าน้อยสุด เนื่องจากมีมวลอะตอมน้อยสุด [1]

จากผลการทดลองที่ทำการวัดการเคลื่อนที่ของพลาสมาในช่วงท้ายของการเคลื่อนที่ และ เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองทางทฤษฏีและจากการวิเคราะห์ลักษณะของสัญญาณที่ได้จาก หัววัดสนามแม่เหล็ก (ที่บันทึกได้จากการออลซิลโลสโคป ในบทที่ 4) ทำให้ทราบว่าความเร็วของ พลาสมาเพิ่มขึ้นในช่วงแรกและลดลงในช่วงท้ายซึ่งสอดคล้องกัน เนื่องจากเมื่อเคลื่อนที่ลึกมากขึ้น ก๊าซที่ถูกกวาดก็จะมีความดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนพลาสมามีความเร็วลดลงในที่สุดและก๊าซที่มี มวลอะตอมน้อยกว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ใกล้ศูนย์กลางมากกว่า จากแบบจำลองทางทฤษฏีพบว่า พลาสมาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใกล้ศูนย์กลางมากกว่า จากแบบจำลองทางทฤษฏีพบว่า พลาสมาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใกล้ศูนย์กลางมากกว่า จากแบบจำลองทางทฤษฏีพบว่า พลาสมาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เกล้ศูนย์กลางมากกว่า จากแบบจำลองทางทฤษฏีพบว่า กว่ามาก กลับไม่ทำให้ความเร็วของพลาสมาโดยรวมแตกต่างกันมากนัก สาเหตุที่ความเร็วเฉลี่ยใน การเคลื่อนที่ของพลาสมาภายในเครื่องที่ต้าพินซ์ไม่ได้อยู่ในระดับต่างกับเครื่องที่ต้าพินซ์ที่ มากถว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กต่อเวลาจึงมีค่ามาก การปรับตัวด้านการ เปลี่ยนแปลงของพลาสมาที่งถึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การปรับตัวอาจเป็นการหมุนวนของ กระแสพลาสมาที่เร็วเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กต้านสนามแม่เหล็กจากภายนอกที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วและส่งผลต่อความเร็วในแนวรัศมีที่ทำการวัดในที่สุด

ผลจากแบบจำลองทางทฤษฎีแสดงให้เห็นว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิอิเล็กตรอน ลดลง เนื่องจากที่ความดันสูงพลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการทำให้ก๊าซแตกตัว ขณะที่ความดัน ต่ำจำนวนอนุภาคในพลาสมาน้อยลง พลังงานที่ให้ไปใช้ในการแตกตัวและยังใช้ไปกับการเร่ง พลาสมาให้เคลื่อนที่ [1] อุณหภูมิอิเล็กตรอนในช่วงความดันต่ำจึงสูงกว่าที่ความดันสูง ซึ่ง สอดคล้องกับการทดลองวัดความเร็วของพลาสมา ซึ่งพบว่าที่ความดันต่ำลงความเร็วของพลาสมา จะสูงขึ้น ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบตามชนิดของก๊าซพบกว่าอาร์กอนมีอุณหภูมิอิเล็กตรอนสูงสุด ตามด้วยออกซิเจนและไนโตรเจนตามลำดับ อุณหภูมิอิเล็กตรอนที่ได้จากแบบจำลองทางทฤษฏีไม่ สอดคล้องกับการวัดการเคลื่อนที่ของพลาสมาเนื่องจากผลจากแบบจำลองทางทฤษฏีได้ กำหนดให้ก๊าซทุกโมเลกุลเกิดการแตกตัวหมด ก๊าซที่มีพลังงานในการสลายพันธะสูงจึงใช้พลังงาน มากกว่าและเหลือพลังงานสำหรับการแตกตัวเป็นพลาสมาและการเร่งน้อยกว่า จึงมีอุณหภูมิ อิเล็กตรอนต่ำกว่าตามลำดับ เป็นสาเหตุให้ผลที่ได้จากแบบจำลองทางทฤษฏีไม่สอดคล้องกับการ ทดลอง ขณะที่ผลที่ได้จากการวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ พบว่าเมื่อ เปรียบเทียบผลที่ได้ตามชนิดของก๊าซ ความดัน และพลังงานที่ให้ ค่าที่ได้มีแนวโน้มที่ไม่สอดคล้อง กัน การวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนด้วยวิธีการและการจัดวางหัววัดตามลักษณะในงานวิจัยครั้งนี้ จึงยัง ไม่ใช่ตำแหน่งและสภาวะของการวัดที่ให้ผลดีสุด ซึ่งอาจเกิดจากความยาวคลื่นของรังสีส่วนใหญ่ที่ แผ่ออกมาจากพลาสมาอยู่นอกช่วงที่เครื่องสเปคโตรมิเตอร์สามารถรับได้[1]

6.3 ข้อเสนอแนะสำหรับงานในอนาคต

ควรปรับปรุงออกแบบเครื่องพีไอซีพีให้สามารถคายประจุได้รวดเร็วขึ้นเพื่อดูการ เปลี่ยนแปลงความเร็วเฉลี่ยของพลาสมาว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร และเพื่อเป็นการพิสูจน์ สมมุติฐานที่ว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าในวงจรของเครื่องนั้นมีผลต่อความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ ตามแนวรัศมีของพลาสมา

งานวิจัยครั้งนี้ พลังงานจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจรของเครื่องนั้นส่วนหนึ่งจะต้อง ถูกใช้ไปในการทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นพลาสมา ส่วนที่เหลือใช้ในการเร่งให้พลาสมาเคลื่อนที่ งาน ในอนาคตจึงควรหาวิธีการทำให้ภายในภาชนะสุญญากาศมีพลาสมาอยู่ก่อนแล้วจึงทำการปล่อย ประจุจากตัวเก็บประจุ ให้พลังงานจากกระแสไฟฟ้านั้นใช้ไปสำหรับการเร่งพลาสมาแต่เพียงอย่าง เดียว อาจสามารถพบเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแตกต่างออกไป

รายการอ้างอิง

- Kamsing, P. <u>Measurement of Plasma Properties from a Theta Pinch Device</u>.
 Master's Thesis, Department of Physics Facultry of science Chulalongkorn University,2006.
- [2] Pimpan, V., Chuenchon, S., Kamsing, P. and Mongkolnavin, R. <u>Properties and Morphology of Surface-Modified Polypropylene Fibers Using Theta-pinch Device</u>, Abstracts to International Meeting on Frontiers of Physics 2005, 25 -29, Kuala lumper, Malaysia.2005.
- [3] Eissa, M. A. Plasma Parameter in The Thetatron. <u>Laser and Plasma Technology</u>. 403-411. Singapore : World Scientific Publishing, 1988.
- [4] Shang, B. <u>Comparative Study of Dynamics and X-Ray Emission of Serveral Plasma</u> <u>Focus Device</u>, Doctoral dissertation, Physics Division, School of Science, Nangyang Technology University, 2000.
- [5] Fridman, A. and Kennedy, L. A. <u>Plasma Physics and Engineering</u>. United state: Taylor & Francis Group Press, 2004.
- [6] GRIEM, H. R. <u>Principles of Plasma Spectroscopy</u>. 2. United Kingdom. Cambridge University Press, 1997.
- [7] Wong, C. S. <u>Elements of Plasma Technology</u> Physics Department, Malaysia, University of Malaya, 2002
- [8] Lee, S., Tan, B. C., Wong, C.S. and Chew, A.C. <u>Laser and plasma Technology</u>.Proc. Second Tropical College on Applied Physics: World Scientific, 1986.
- [9] AAAPT. <u>Twelve Years of UNU/ICTP PFF-A Review</u>, The United Nation University, 1963.
- [10] Lee, S. Laser and Plasma Technology, <u>Proceedings of the First Tropical College</u> <u>on Applied Physics</u>, Malaysia (1983).
- [11] Ong, C. X., Wong, C. S. and Chew, A. C. Characteristics of A Torodal Helium Plasma. <u>Second Tropical Collage on Applied Physics Laser and Plasma</u> <u>Technology.</u> (17 March – 5 April 1987) : 441-448.
- [12] Mao-fu, Y. Discharge Current Measurement By Rogowski Coil. <u>Proceedings of</u> <u>Plasma Physics: Diagnostics.</u> (30 October-9 November 1989): 46-50.
- [13] Kieft, E.R., Mullen, V. D. and Banine, V.Y. <u>Sub-ns Thomson scattering applied to</u> an EUV emitting vacuum arc discharge in tin vapor, <u>XXVIIth</u> <u>ICPIG</u> (2005): 8-13.
- [14] Tangjitsomboon, P. <u>Plasma Focus Device Modification for Generating of Extreame</u> <u>Ultraviolet Radiation</u>. Master's Thesis, Department of Physics Facultry of science Chulalongkorn University,2009.
- [15] Khaymapanya, P., Kamsing, P., Mongkolnavin, R. and Pimpan, V. Surface Modification of Polyester Fabric Using Plasma Generated from Theta-Pinch Device. <u>Proceedings to The 14th Academic Symposium of Faculty of Science.</u> <u>Chulalongkorn University.</u> Bangkok, Thailand. (16-17 March 2006).
- [16]. Alani, R., Azodi, H., Naraghi, M., Safaii, B. and Torabi-Fard, A. <u>Material testing in a</u> <u>linear theta pinch</u>. <u>J. of Nuc. Material</u>. 13, (1983) : 25-32
- [17] Pedrow, P. D. and Nasiruddin, A. M. Experimental Study of CF₄ Conical Theta Pinch Plasma Expanding into Vacuum. <u>IEEE Transaction on Plasma Science.</u> 17, 1, (February 1989) : 17-23.

- [18] Trigueiros, A., Pettersson, S. G. and Almandos, J. G. R. Transitions within the n=4 complex of Kr VII obtained fron a Theta-Pinch Light Source. <u>Physics Scripta.</u> 34, (1986) : 164-166.
- [19] Pedrow, P. D., Goyal, K. O., Mahalingam, R., and Osman, M. A. Explosion model applied to an intense pulsed plasma source for thin film deposition. <u>IEEE</u> <u>Transactions on plasma sciecnce</u>, 25, 1, (February 1977) : 89-96
- [20] Luna, F. R. T., Cavalcanti G.H. and Trigueiros, A. G. A theta-pinch as a spectroscopic light source. J. Phys. D: Appl. Phys. 31, (1998) : 866-872



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<mark>ภาค</mark>ผนวก



1 ฝาปิดภาชนะสุญญากาศ













2 ชุดแท่นวางภาชนะสุญญากาศ







3 ขั้วและข้อต่อสปาร์คแก๊บสวิทช์



A 460 mm ieis (ii) lowin 21.5 **** 35 1Pm 25 m с 250 mm ieio 1/11 C 100m 10 mm 25 350 -55 mm D 245 mm

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล นายสิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ

เกิด วันที่ 2 ธันวาคม 2526

การศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน ปี พ.ศ. 2549, จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2545, จบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2543 ผลงานที่ผ่านมา

[1] S. Chaisombat1, D. Ngamrungroj, P. Tangjitsomboon and R. Mongkolnavin.
Plasma Dynamics Simulation in Small Theta Pinch Device, 5th Siam Physics
Congress(SPC2010), Kanchanaburi, Thailand(Oral)

ประวัติการทำงาน

- Research Assistance in Influence of Plasma Threatment on Activated Carbon Project 2008-2009
- Research Assistance in Corona treatment of expanded PTFE Project 2009-2010
- อาจารย์พิเศ<mark>ษโรงเรียนไทยคริสเตียนศึกษาปีการศึกษ</mark>า 2553 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย